

POWERED BY **Dialog**

Surface position setting equipment for auto focus mechanism - includes synchronised scanning of mask and sensitisation substrate, and combines exposure surface of substrate with image face

Patent Assignee: NIKON CORP

Inventors: MURAKAMI S; NISHI K; SAKAKIBARA Y; TANAKA Y

Patent Family

| Patent Number | Kind | Date | Application Number | Kind | Date | Week | Type |
|---------------|------|----------|--------------------|------|----------|--------|------|
| JP 6283403 | A | 19941007 | JP 9367271 | A | 19930326 | 199445 | B |
| US 5448332 | A | 19950905 | US 93172098 | A | 19931223 | 199541 | |
| | | | US 94345325 | A | 19941121 | | |
| US 5693439 | A | 19971202 | US 93172098 | A | 19931223 | 199803 | |
| | | | US 94345325 | A | 19941121 | | |
| | | | US 95482555 | A | 19950607 | | |
| KR 300627 | B | 20010922 | KR 9910827 | A | 19990329 | 200230 | |
| | | | KR 20019581 | A | 20010226 | | |
| KR 306310 | B | 20010924 | KR 9330163 | A | 19931224 | 200233 | |
| | | | KR 9910827 | A | 19990329 | | |
| KR 306311 | B | 20010924 | KR 9330163 | A | 19931224 | 200233 | |
| | | | KR 9911934 | A | 19990329 | | |
| KR 307049 | B | 20010924 | KR 9330163 | A | 19931224 | 200233 | |
| | | | KR 9910828 | A | 19990329 | | |
| KR 311427 | B | 20011102 | KR 9330163 | A | 19931224 | 200238 | |
| | | | KR 9911935 | A | 19990329 | | |
| KR 300618 | B | 20011122 | KR 9330163 | A | 19931224 | 200243 | |
| KR 313732 | B | 20011129 | KR 9910827 | A | 19990329 | 200246 | |
| | | | KR 20019582 | A | 20010226 | | |
| US 6433872 | B1 | 20020813 | US 93172098 | A | 19931223 | 200255 | |
| | | | US 94345325 | A | 19941121 | | |
| | | | US 95482555 | A | 19950607 | | |
| | | | US 97909739 | A | 19970812 | | |
| | | | US 99276441 | A | 19990325 | | |
| JP 3316833 | B2 | 20020819 | JP 9367271 | A | 19930326 | 200261 | |
| KR 325193 | B | 20020313 | KR 9911934 | A | 19990329 | 200263 | |
| | | | KR 20019876 | A | 20010227 | | |
| KR 325182 | B | 20020325 | KR 9330163 | A | 19931224 | 200265 | |

| | | | | | | |
|----------------|----|----------|---------------|---|----------|--------|
| | | | KR 9910829 | A | 19990329 | |
| KR 325184 | B | 20020325 | KR 9910829 | A | 19990329 | 200265 |
| | | | KR 9915291 | A | 19990428 | |
| US 20020176082 | A1 | 20021128 | US 93172098 | A | 19931223 | 200281 |
| | | | US 94345325 | A | 19941121 | |
| | | | US 95482555 | A | 19950607 | |
| | | | US 97909739 | A | 19970812 | |
| | | | US 99276441 | A | 19990325 | |
| | | | US 2002186687 | A | 20020702 | |
| US 6608681 | B2 | 20030819 | US 93172098 | A | 19931223 | 200356 |
| | | | US 94345325 | A | 19941121 | |
| | | | US 95482555 | A | 19950607 | |
| | | | US 97909739 | A | 19970812 | |
| | | | US 99276441 | A | 19990325 | |
| | | | US 2002186687 | A | 20020702 | |

Priority Applications (Number Kind Date): JP 9367271 A (19930326); JP 92346073 A (19921225); JP 9342426 A (19930303)

Patent Details

| Patent | Kind | Language | Page | Main IPC | Filing Notes |
|------------|------|----------|------|--------------|-----------------------------------|
| JP 6283403 | A | | 21 | H01L-021/027 | |
| US 5448332 | A | | 45 | G03B-027/42 | Cont of application US 93172098 |
| US 5693439 | A | | 43 | G03F-007/207 | Cont of application US 93172098 |
| | | | | | Div ex application US 94345325 |
| | | | | | Div ex patent US 5448332 |
| KR 300627 | B | | | G03F-007/207 | Div ex application KR 9910827 |
| KR 306310 | B | | | G03F-007/207 | Div ex application KR 9330163 |
| KR 306311 | B | | | G03F-007/207 | Div ex application KR 9330163 |
| KR 307049 | B | | | G03F-009/02 | Div ex application KR 9330163 |
| KR 311427 | B | | | H01L-021/027 | Div ex application KR 9330163 |
| KR 300618 | B | | | G03F-007/207 | Previous Publ. patent KR 94015697 |
| KR 313732 | B | | | H01L-021/027 | Div ex application KR 9910827 |
| US 6433872 | B1 | | | G01B-011/00 | Cont of application US 93172098 |
| | | | | | Div ex application US 94345325 |
| | | | | | Div ex application US 95482555 |
| | | | | | Cont of application US 97909739 |
| | | | | | Div ex patent US 5448332 |
| | | | | | Div ex patent US 5693439 |

| | | | | | |
|----------------|----|--|----|--------------|----------------------------------|
| JP 3316833 | B2 | | 24 | H01L-021/027 | Previous Publ. patent JP 6283403 |
| KR 325193 | B | | | G03F-007/207 | Div ex application KR 9911934 |
| KR 325182 | B | | | G03F-007/207 | Div ex application KR 9330163 |
| KR 325184 | B | | | G03F-007/207 | Div ex application KR 9910829 |
| US 20020176082 | A1 | | | G01B-011/00 | Cont of application US 93172098 |
| | | | | | Div ex application US 94345325 |
| | | | | | Div ex application US 95482555 |
| | | | | | Cont of application US 97909739 |
| | | | | | Div ex application US 99276441 |
| | | | | | Div ex patent US 5448332 |
| | | | | | Div ex patent US 5693439 |
| | | | | | Div ex patent US 6433872 |
| US 6608681 | B2 | | | G01B-011/00 | Cont of application US 93172098 |
| | | | | | Div ex application US 94345325 |
| | | | | | Div ex application US 95482555 |
| | | | | | Cont of application US 97909739 |
| | | | | | Div ex application US 99276441 |
| | | | | | Div ex patent US 5448332 |
| | | | | | Div ex patent US 5693439 |
| | | | | | Div ex patent US 6433872 |

Abstract:

JP 6283403 A

The surface position setting equipment consists of a mask side stage and a substrate side stage. The substrate side stage is formed in an exposure field. The mask and the sensitisation substrate are scanned synchronously so that exposure patterns are formed in a lighting region which is illuminated by a projection optical system.

The scanning of sample points arranged in a second sequence and sample points arranged in a fourth sequence is carried out along the Y and -Y directions respectively towards the sample points formed in the exposure field.

USE/ADVANTAGE - For use in projection exposure system of slit scan exposure systems for mfg. semiconductor devices, LCDs, or thin-film magnetic heads. Rectifies measurement accuracy and air fluctuation.

Dwg.1/21

US 5693439 A

The surface position setting equipment consists of a mask side stage and a substrate side stage. The substrate side stage is formed in an exposure field. The mask and the sensitisation substrate are scanned

synchronously so that exposure patterns are formed in a lighting region which is illuminated by a projection optical system.

The scanning of sample points arranged in a second sequence and sample points arranged in a fourth sequence is carried out along the Y and -Y directions respectively towards the sample points formed in the exposure field.

USE/ADVANTAGE - For use in projection exposure system of slit scan exposure systems for mfg. semiconductor devices, LCDs, or thin-film magnetic heads. Rectifies measurement accuracy and air fluctuation.

Dwg.4/28c

US 5448332 A

The pattern transfer photolithographic system exposes a pattern, formed on a mask, onto each of a number of partitioned areas on a photosensitive substrate in a step-and-repeat operation. The exposure system includes a projection optical system to project the mask pattern onto the substrate, a substrate stage to two-dimensionally move the substrate within a plane perpendicular to the projection optical system optical axis, and a detection unit to project a pattern image of preset shape onto the substrate and photoelectrically detect light reflected from the substrate in order to detect a positions of points on the substrate along the optical system axis.

A measurement unit detects an offset between an imaging plane of the optical system and the next partitioned area along the optical axis during a stepping operation of the substrate stage, when an individual measurement point in a partitioned area on which the mask pattern is to be exposed next coincides with or approaches the pattern image. The imaging plane and the next partitioned area are relatively moved along the optical axis in accordance with the measured offset amount before the mask pattern is exposed on the next partitioned area.

USE/ADVANTAGE - Semiconductor, LCD and thin film magnetic head mfr.; positions substrate w.r.t. projection optical system imaging plane. High precision, high speed alignment, with focussing and levelling completed during substrate stage movement, or immediately after stage movement.

Dwg.1/28

Derwent World Patents Index

© 2004 Derwent Information Ltd. All rights reserved.

Dialog® File Number 351 Accession Number 10093633

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平6-283403

(43)公開日 平成6年(1994)10月7日

| (51)Int.Cl. ⁵ | 識別記号 | 庁内整理番号 | F I | 技術表示箇所 |
|------------------------------|------|---------|----------------|---------|
| H 0 1 L 21/027 | | | | |
| G 0 3 B 27/32 | F | 8102-2K | | |
| G 0 3 F 9/00 | H | 7316-2H | | |
| | | 7352-4M | | |
| | | | H 0 1 L 21/ 30 | 3 1 1 N |
| 審査請求 未請求 請求項の数5 O L (全 21 頁) | | | | |

(21)出願番号 特願平5-67271

(22)出願日 平成5年(1993)3月26日

(71)出願人 000004112

株式会社ニコン

東京都千代田区丸の内3丁目2番3号

(72)発明者 西 健爾

東京都千代田区丸の内3丁目2番3号 株式会社ニコン内

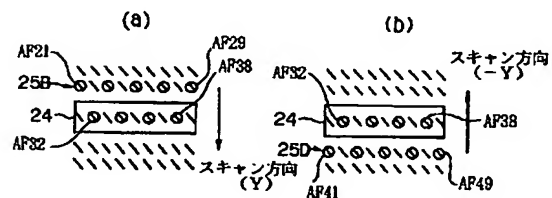
(74)代理人 弁理士 大森 聡

(54)【発明の名称】 面位置設定装置

(57)【要約】

【目的】 スリットスキャン露光方式の投影露光装置において、感光基板の露光面を投影光学系の像面に対して高精度に合わせ込む。

【構成】 スリット状の露光フィールド24に対してウエハをY方向に走査して露光を行う場合には、走査方向に対して手前の第2列25B内のサンプル点AF21～AF29及び露光フィールド24内のサンプル点AF32～AF38で得られたフォーカス位置の情報からウエハのレベリング及びフォーカシングの制御を行う。また、ウエハを-Y方向に走査して露光を行う場合には、走査方向に対して手前の第4列25D内のサンプル点AF41～AF49及び露光フィールド24内のサンプル点AF32～AF38で得られたフォーカス位置の情報からウエハのレベリング及びフォーカシングの制御を行う。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 露光光で所定形状の照明領域を照明する照明光学系と、前記照明領域に対して露光用のパターンが形成されたマスクを走査するマスク側ステージと、前記照明領域内の前記マスクのパターンを感光基板上に投影する投影光学系と、前記マスクと同期して前記感光基板を走査する基板側ステージとを有する露光装置に設けられ、前記感光基板の露光面を前記投影光学系の像面に平行に合わせ込むための面位置設定装置であって、前記感光基板が走査される方向に交差する方向の複数の点を含む複数の計測点において前記感光基板の前記投影光学系の光軸に平行な方向の高さをそれぞれ計測する多点計測手段と、該多点計測手段の計測結果より前記感光基板の露光面と前記投影光学系の像面との間の傾斜角の差分を求める演算手段と、前記基板側ステージに設けられ、前記演算手段により求められた前記傾斜角の差分に基づいて、前記感光基板の前記走査の方向の傾斜角及び前記走査の方向に直交する方向の傾斜角を設定する傾斜設定ステージとを有し、該傾斜設定ステージが前記感光基板の前記走査の方向の傾斜角を設定するときの応答速度と、前記走査の方向に直交する方向の傾斜角を設定するときの応答速度とを異ならしめたことを特徴とする面位置設定装置。

【請求項2】 前記多点計測手段は、前記基板側ステージを介して前記感光基板が走査されているときに、前記基板側ステージの位置基準で前記複数の計測点における前記感光基板の高さをサンプリングすることを特徴とする請求項1記載の面位置設定装置。

【請求項3】 前記多点計測手段は、前記所定形状の照明領域と前記投影光学系に関して共役な露光領域内の複数の点及び前記共役な露光領域内に対して前記感光基板が走査される際の手前の領域内の複数の点よりなる複数の計測点において、前記感光基板の高さをそれぞれ計測することを特徴とする請求項1又は2記載の面位置設定装置。

【請求項4】 前記多点計測手段は、前記感光基板の1つのショット領域へ順次前記マスクのパターンを露光する過程において、順次前記複数の計測点の位置を変化させることを特徴とする請求項1記載の面位置設定装置。

【請求項5】 露光光で所定形状の照明領域を照明する照明光学系と、前記照明領域に対して露光用のパターンが形成されたマスクを走査するマスク側ステージと、前記照明領域内の前記マスクのパターンを感光基板上に投影する投影光学系と、前記マスクと同期して前記感光基板を走査する基板側ステージとを有する露光装置に設けられ、前記感光基板の露光面の高さを前記投影光学系の像面に合わせ込むための面位置設定装置であって、前記所定形状の照明領域と前記投影光学系に関して共役な露光領域及び該露光領域に対して前記感光基板が走査

される際の手前の領域よりなる計測領域内の所定の計測点において、前記感光基板の前記投影光学系の光軸に平行な方向の高さを計測する高さ計測手段と、前記感光基板を走査した際に前記高さ計測手段により得られる複数の高さ計測結果の内の、最大値及び最小値に基づいて前記感光基板の露光面の平均的な高さと前記投影光学系の像面の高さとの差分を求める演算手段と、前記基板側ステージに設けられ、前記演算手段により求められた前記高さの差分に基づいて、前記感光基板の高さを設定する高さ設定ステージとを有することを特徴とする面位置設定装置。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【産業上の利用分野】本発明は、例えばスリットスキャン露光方式の投影露光装置のオートフォーカス機構又はオートレベリング機構に適用して好適な面位置設定装置に関する。

【0002】

【従来の技術】半導体素子、液晶表示素子又は薄膜磁気ヘッド等をフォトリソグラフィ工程で製造する際に、フォトマスク又はレチクル（以下、「レチクル」と総称する）のパターンを感光材が塗布された基板（ウエハ、ガラスプレート等）上に転写する投影露光装置が使用されている。従来の投影露光装置としては、ウエハの各ショット領域を順次投影光学系の露光フィールド内に移動させて、各ショット領域に順次レチクルのパターン像を露光するというステップ・アンド・リピート方式の縮小投影型露光装置（ステッパー）が多く使用されていた。

【0003】図20は従来のステッパーの要部を示し、この図20において、図示省略された照明光学系からの露光光ELのもとで、レチクル51上のパターンの像が投影光学系52を介してフォトリソグが塗布されたウエハ53上の各ショット領域に投影露光される。ウエハ53は、Zレベリングステージ54上に保持され、Zレベリングステージ54はウエハ側XYステージ55の上に載置されている。ウエハ側XYステージ55は、投影光学系52の光軸AX1に垂直な平面（XY平面）内でウエハ53の位置決めを行い、Zレベリングステージ54は、ウエハ53の露光面のフォーカス位置（光軸AX1に平行な方向の位置）及びその露光面の傾斜角を指定された状態に設定する。

【0004】また、Zレベリングステージ54上に、移動鏡56が固定されている。外部のレーザ干渉計57からのレーザビームがその移動鏡56で反射され、ウエハ側XYステージ55のX座標及びY座標がレーザ干渉計57により常時検出され、これらX座標及びY座標が主制御系58に供給されている。主制御系58は、駆動装置59を介してウエハ側XYステージ55及びZレベリングステージ54の動作を制御することにより、ステップ・アンド・リピート方式でウエハ53上の各ショット

領域に順次レチクル51のパターン像を露光する。

【0005】この際、レチクル51上のパターン形成面（レチクル面）とウエハ53の露光面とは投影光学系52に関して共役になっている必要があるが、投影倍率が高く、焦点深度が大きい為にレチクル面はあまり変動しない。そこで、従来は一般に、斜め入射型の多点のフォーカス位置検出系によってウエハ53の露光面が投影光学系52の像面に焦点深度の範囲内で合致しているかどうか（合焦しているかどうか）のみを検出し、ウエハ53の露光面のフォーカス位置及び傾斜角の制御を行っていた。

【0006】従来の多点のフォーカス位置検出系において、露光光ELとは異なりウエハ53上のフォトレジストを感光させない照明光が、図示省略された照明光源から光ファイバ束60を介して導かれている。光ファイバ束60から射出された照明光は、集光レンズ61を経てパターン形成板62を照明する。パターン形成板62を透過した照明光は、レンズ63、ミラー64及び照射対物レンズ65を経てウエハ53の露光面に投影され、ウエハ53の露光面にはパターン形成板62上のパターンの像が光軸AX1に対して斜めに投影結像される。ウエハ53で反射された照明光は、集光対物レンズ66、回転方向振動板67及び結像レンズ68を経て受光器69に受光面に再投影され、受光器69の受光面には、パターン形成板62上のパターンの像が再結像される。この場合、主制御系58は加振装置70を介して回転方向振動板67に後述のような振動を与え、受光器69の多数の受光素子からの検出信号が信号処理装置71に供給され、信号処理装置71は、各検出信号を加振装置70の駆動信号で同期検波して得た多数のフォーカス信号を主制御系58に供給する。

【0007】図21（b）は、パターン形成板62上に形成された開口パターンを示し、この図21（b）に示すように、パターン形成板62上には十字状に9個のスリット状の開口パターン72-1～72-9が設けられている。それらの開口パターン72-1～72-9はウエハ53の露光面に対してX軸及びY軸に対して45°で交差する方向から照射されるため、ウエハ53の露光面上の投影光学系52の露光フィールド内での、それら開口パターン72-1～72-9の各投影像AF1～AF9は図21（a）に示すような配置になる。図21

（a）において、投影光学系52の円形の照明視野に直接して最大露光フィールド74が形成され、最大露光フィールド74内の中央部及び2個の対角線上の計測点AF1～AF9にそれぞれスリット状の開口パターンの投影像が投影されている。

【0008】図21（c）は、受光器69の受光面の様子を示し、この図21（c）に示すように、受光器69の受光面には十字型に9個の受光素子75-1～75-9が配置され、各受光素子75-1～75-9の上には

スリット状の開口を有する遮光板（図示省略）が配置されている。そして、図21（a）の各計測点AF1～AF9上の像がそれぞれ受光器69の各受光素子75-1～75-9の上に再結像されている。この場合、図20のウエハ53の露光面（ウエハ面）で反射された照明光は、集光対物レンズ66の瞳位置に存在すると共に図20の紙面にほぼ垂直な軸の回りに振動（回転振動）する回転方向振動板67に反射されるため、図21（c）に示すように、受光器69上では各受光素子75-1～75-9上に再結像される投影像の位置がスリット状の開口の幅方向であるRD方向に振動する。

【0009】また、図21（a）の各計測点AF1～AF9上のスリット状の開口の像は、投影光学系52の光軸に対して斜めに投影されているため、ウエハ53の露光面のフォーカス位置が変化すると、それら投影像の受光器69上での再結像位置はRD方向に変化する。従って、信号処理装置71内で、各受光素子75-1～75-9の検出信号をそれぞれ回転方向振動板67の加振信号で同期検波することで、計測点AF1～AF9のフォーカス位置にそれぞれ対応する9個のフォーカス信号が得られる。そして、9個のフォーカス位置から、露光フィールド74の平均的な面の傾斜角及びその平均的な面のフォーカス位置が求められて主制御系58に供給され、主制御系58は、駆動装置59及びZレベリングステージ54を介してウエハ53の当該ショット領域のフォーカス位置及び傾斜角（レベリング角）を所定の値に設定する。このようにして、ステッパーにおいては、ウエハ53の各ショット領域においてフォーカス位置及び傾斜角が投影光学系52の像面に合わせ込まれた状態で、それぞれレチクル51のパターン像が露光されている。

【0010】

【発明が解決しようとする課題】近年、半導体素子等においてはパターンが微細化しているため、投影光学系の解像力を高めることが求められている。解像力を高めるための手法には、露光光の波長の短波長化、又は投影光学系の開口数の増大等の手法があるが、何れの手法を用いる場合でも、従来例と同じ程度の露光フィールドを確保しようとする、露光フィールドの全面で結像性能（ディストーション、像面湾曲等）を所定の精度に維持することが困難になってきている。そこで現在見直されているのが、所謂スリットスキャン露光方式の投影露光装置である。

【0011】このスリットスキャン露光方式の投影露光装置では、矩形状又は円弧状等の照明領域（以下、「スリット状の照明領域」という）に対してレチクル及びウエハを相対的に同期して走査しながら、そのレチクルのパターンがウエハ上に露光される。従って、前記スリット状の照明領域と共役な領域内で像が平均化され、ディストーション精度が向上するという利点があった。

【0012】また、従来のレチクルの大きさの主流は6インチサイズであり、投影光学系の投影倍率の主流は1/5倍であったが、半導体素子等の回路パターンの大面積化により、倍率1/5倍のもとでのレチクルの大きさは6インチサイズでは間に合わなくなっている。そのため、投影光学系の投影倍率を例えば1/4倍に変更した投影露光装置を設計する必要がある。そして、このような被転写パターンの大面積化に対して投影光学系の露光フィールド径を小さくする事ができるスリットスキャン露光方式がコスト面に於いても有利である。

【0013】斯かるスリットスキャン露光方式の投影露光装置において、従来のステッパーで用いられていた多点型のフォーカス位置検出系をそのまま適用して、ウェハ上の露光面のフォーカス位置及び傾斜角を計測したとしても、ウェハが所定の方向に走査されているため、実際の露光面を投影光学系の像面に合わせ込むことが困難であるという不都合があった。即ち、従来はスリットスキャン露光方式の投影露光装置において、ウェハのフォーカス位置及び傾斜角を投影光学系の像面に合わせ込むための手法が確率されていなかった。

【0014】本発明は斯かる点に鑑み、スリットスキャン露光方式の投影露光装置において、感光基板の露光面を投影光学系の像面に対して高精度に合わせ込むために使用できるような面位置設定装置を提供することを目的とする。

【0015】

【課題を解決するための手段】本発明の第1の面位置設定装置は、露光光で所定形状の照明領域を照明する照明光学系と、その照明領域に対して露光用のパターンが形成されたマスク(12)を走査するマスク側ステージ

(10)と、その照明領域内のマスク(12)のパターンを感光基板(5)上に投影する投影光学系(8)と、マスク(12)と同期して感光基板(5)を走査する基板側ステージ(2)とを有する露光装置に設けられ、感光基板(5)の露光面を投影光学系(8)の像面に平行に合わせ込むための面位置設定装置であって、感光基板(5)が走査される方向に交差する方向の複数の点を含む複数の計測点(AF11~AF59)において感光基板(5)の投影光学系(8)の光軸に平行な方向の高さをそれぞれ計測する多点計測手段(62A, 69A)と、この多点計測手段の計測結果より感光基板(5)の露光面と投影光学系(8)の像面との間の傾斜角の差を求める演算手段(71A)とを有する。

【0016】更に本発明は、基板側ステージ(2)に設けられ、演算手段(71A)により求められたその傾斜角の差分に基づいて、感光基板(5)のその走査の方向(Y方向)の傾斜角及びその走査の方向に直交する方向(X方向)の傾斜角を設定する傾斜設定ステージ(4)を有し、例えば図5に示すように、傾斜設定ステージ(4)が感光基板(5)のその走査の方向(Y方向)の

傾斜角 θ_y を設定するときの応答速度と、その走査の方向に直交する方向(X方向)の傾斜角 θ_x を設定するときの応答速度とを異ならしめたものである。

【0017】この場合、その多点計測手段は、基板側ステージ(2)を介して感光基板(5)が走査されているときに、基板側ステージ(2)の位置基準でそれら複数の計測点における感光基板(5)の高さをサンプリングしても良い。また、その多点計測手段は、その所定形状の照明領域と投影光学系(8)に関して共役な露光領域(24)内の複数の点及びその共役な露光領域内に対して感光基板(5)が走査される際の手前の領域内の複数の点よりなる複数の計測点において、感光基板(5)の高さをそれぞれ計測するものであっても良い。

【0018】また、その多点計測手段は、感光基板

(5)の1つのショット領域へ順次マスク(12)のパターンを露光する過程において、順次それら複数の計測点の位置を変化させることが望ましい。また、本発明による第2の面位置設定装置は、露光光で所定形状の照明領域を照明する照明光学系と、その照明領域に対して露光用のパターンが形成されたマスク(12)を走査するマスク側ステージ(10)と、その照明領域内のマスク(12)のパターンを感光基板(5)上に投影する投影光学系(8)と、マスク(12)と同期して感光基板(5)を走査する基板側ステージ(2)とを有する露光装置に設けられ、感光基板(5)の露光面の高さを投影光学系(8)の像面に合わせ込むための面位置設定装置であって、その所定形状の照明領域と投影光学系(8)に関して共役な露光領域(24)及びこの露光領域に対して感光基板(5)が走査される際の手前の領域よりなる計測領域内の所定の計測点において、感光基板(5)の投影光学系(8)の光軸に平行な方向の高さを計測する高さ計測手段(62A, 69A)と、感光基板(5)を走査した際にその高さ計測手段により得られる複数の高さ計測結果の内の、最大値及び最小値に基づいて感光基板(5)の露光面の平均的な高さと投影光学系(8)の像面の高さとの差分を求める演算手段(71A)と、基板側ステージ(2)に設けられ、演算手段(71A)により求められたその高さの差分に基づいて、感光基板(5)の高さを設定する高さ設定ステージ(4)とを有するものである。

【0019】

【作用】斯かる本発明の第1の面位置設定装置においては、マスク(12)及び感光基板(5)を同期して走査して感光基板(5)上にマスク(12)のパターン像を露光する際に、例えばその走査の方向の手前の計測点を含む複数の計測点でその多点計測手段を用いて感光基板(5)の高さを計測する。そして、それら複数の計測点でそれぞれ走査の方向に沿って複数回高さ情報を得ることにより、感光基板(5)の傾斜角を求める。その後、そのように傾斜角が求められた領域にマスク(12)の

パターン像を露光する際に、予め求めた傾斜角に基づいてその領域の傾斜角を設定する。これにより、スリットスキャン露光方式でも感光基板(5)の露光面が投影光学系(8)の像面に平行に設定される。

【0020】また、本発明ではそのようなレベリングを行う際に、スキャン方向のレベリングの応答速度と、非スキャン方向レベリングの応答速度とが異なっている。これによる作用効果につき説明するため、スリットスキャン露光時のフォーカシング及びレベリングの誤差要因について説明する。スリットスキャン露光方式の露光装置では、以下の誤差が考えられる。

①フォーカスオフセット誤差及び振動誤差

フォーカスオフセット誤差とは、露光面の平均的な面と投影光学系の像面とのフォーカス位置の差であり、振動誤差とは走査露光する際の基板側ステージのフォーカス方向の振動等に起因する誤差である。これについて、オートフォーカス制御だけを行うものとして、ステッパーのように一括露光する場合と、スリットスキャン露光方式で露光する場合とに分けてより詳細に説明する。

【0021】図14(a)は一括露光する場合、図14(b)はスリットスキャン露光方式で露光する場合を示す。図14(a)においては、感光基板の露光面5aの平均的な面34が投影光学系の像面に合致しているが、位置Y_a、Y_b及びY_cのフォーカス位置はそれぞれ一定の平均的な面34に対して、 $-\Delta Z_1$ 、0及び ΔZ_2 だけ異なっている。従って、位置Y_a及びY_bにおけるフォーカスオフセット誤差はそれぞれ $-\Delta Z_1$ 及び ΔZ_2 である。

【0022】一方、図14(b)の場合には、スキャン方向に対して露光面5a上の一連の部分的な平均面35A、35B、35C、……が順次投影光学系の像面に合わせ込まれる。従って、各位置Y_a、Y_b及びY_cでのフォーカスオフセット誤差はそれぞれ平均化効果で0となる。しかし、位置Y_b上の像を形成するのに、平均面35Bから平均面35Dまでの高さ ΔZ_B の間をフォーカス位置が移動するので、位置Y_b上の像は、 ΔZ_B だけフォーカス方向にばらつきを持った像になってしまう。同様に、位置Y_a及びY_c上の像はそれぞれフォーカス方向に ΔZ_A 及び ΔZ_B だけばらつきを持った像になる。

【0023】即ち、スリットスキャン露光方式においては、フォーカスオフセット誤差はある一定周波数以下の感光基板面の凹凸に対しほぼ0になるが、基板側ステージのローリング、ピッチング、フォーカス方向(Z軸方向)の振動、低周波空気揺らぎ誤差にオートフォーカス機構及びオートレベリング機構が追従してしまうことによる誤差成分、露光光(KrFエキシマレーザ光等)の短期の波長変動等が、新たな誤差(振動誤差)を生ずる。

【0024】②フォーカス追従誤差、空気揺らぎ誤差、

ステージ振動誤差

①で言及した振動誤差の内の代表的な例であり、これらはオートフォーカス機構及びオートレベリング機構の応答周波数に依存するが、更に以下の誤差に分類できる。

(1) 制御系で制御出来ない高周波ステージ振動誤差、露光光(KrFエキシマレーザ光等)の短期の波長変動誤差等、(2) 空気揺らぎ誤差の中で、基板側ステージが追従してしまう低周波空気揺らぎ誤差等、(3) フォーカス位置検出系又は傾斜角検出系の測定結果には含まれるが、基板側ステージが追従しないので、フォーカス誤差にならない測定誤差等。

【0025】③感光基板の露光面の凸凹による誤差

この誤差は、投影光学系による露光フィールドが2次元的な面単位であり、感光基板の露光面でのフォーカス位置の計測を有限個の計測点で且つスリットスキャン露光時に行うことに起因する誤差であり、以下の2つの誤差に分類できる。

(1) 例えば図15(a)及び(b)に示すように、感光基板の露光面5a上の多点でフォーカス位置を計測して位置合わせ対象面(フォーカス面)36A及び36Bを求める場合の計測点の位置に対する演算方法に起因する、そのフォーカス面36Aと理想フォーカス面とのずれの誤差、(2) スキャン速度とオートフォーカス機構及びオートレベリング機構の追従速度との差、フォーカス位置検出系の応答速度等による誤差。

【0026】この場合、フォーカス位置を投影光学系の像面に合わせる場合の応答速度(フォーカス応答)は、図15(c)に示すような時間遅れ誤差と、図15

(d)に示すようなサーボゲインとにより決定される。即ち、図15(c)において、曲線37Aは、感光基板の露光面5aの一連の部分領域を順次投影光学系の像面に合わせるためのフォーカス方向用の駆動信号(目標フォーカス位置信号)を示し、曲線38Aは、露光面5aの一連の部分領域のフォーカス方向への移動量を駆動信号に換算して得られた信号(追従フォーカス位置信号)を示す。曲線37Aに対して曲線38Aは一定の時間だけ遅れている。同様に、図15(d)において、曲線37Bは、感光基板の露光面5aの一連の部分領域の目標フォーカス位置信号、曲線38Bは、露光面5aの一連の部分領域の追従フォーカス位置信号であり、曲線37Bに対して曲線38Bの振幅(サーボゲイン)は一定量だけ小さくなっている。

【0027】本発明の第1の面位置設定装置では、これらの誤差を取り除く為に、レベリング機構のスキャン方向の応答性と非スキャン方向の応答性を変えている。本発明におけるオートレベリング機構用の多点計測手段としては、斜入射型の多点のフォーカス位置検出系を前提とする。また、投影光学系の露光フィールド内の所定の領域での感光基板の露光面の平均的な面を考慮するのではなく、その所定の領域での露光面の各点と投影光学

系の像面とのずれの最大値を最小にすることを目標とする。このように、投影光学系の露光フィールド内の所定の領域において、感光基板の露光面のほぼ全ての点と投影光学系の像面とのずれの最大値が最小である場合の露光フィールドを「良好なフィールド (Good Field)」と呼ぶ。

【0028】 先ず、図16に示すように、スリット状の照明領域と投影光学系に関して共役なスリット状の露光フィールド24内にフォーカス位置の多数の計測点(不図示)があると仮定する。図16において、感光基板上の1つのショット領域 SA_{ij} をスリット状の露光フィールド24に対してY方向に速度 V/β で走査するものとして、ショット領域 SA_{ij} のスキヤン方向の幅を WY 、非スキヤン方向の幅を WX 、露光フィールド24のスキヤン方向の幅を D とする。また、露光フィールド24内の中心領域24a内の多数の計測点でのフォーカス位置を平均化することにより、露光フィールド24の中心点での平均的な面のフォーカス位置を求め、露光フィールド24のスキヤン方向の両端の計測領域24b、24c内の計測点でのフォーカス位置より最小自乗近似に基づいて平均的な面のスキヤン方向の傾斜角 θ_y を求め、露光フィールド24の非スキヤン方向の両端の計測領域24b、24c内の計測点でのフォーカス位置より最小自乗近似に基づいて平均的な面の非スキヤン方向の傾斜角 θ_x を求めるものとする。また、スキヤン方向のレベリングの応答周波数を f_m [Hz]、非スキヤン方向のレベリングの応答周波数を f_n [Hz]として、 f_m 及び f_n の値を独立に設定する。

【0029】 そして、感光基板上のショット領域 SA_{ij} のスキヤン方向の周期的な曲がりの周期を、スキヤン方向の幅 WY (非スキヤン方向も同様の曲がり周期に設定する)との比の値として曲がりパラメータ F で表し、その周期的な曲がりがあるときの露光フィールド24内の各計測点でのフォーカス誤差を、スキヤンした場合のフォーカス誤差の平均値の絶対値と、スキヤンした場合のフォーカス誤差の振幅の $1/3$ との和で表す。また、曲がりパラメータ F の周期的な曲がりの振幅を1に規格化し、曲がりパラメータが F であるときの、それら各計測点でのフォーカス誤差の内の最大値を示す誤差パラメータ S を、曲がりパラメータ F に対する比率として表す。即ち、次式が成立している。

$$F = \text{曲がりの周期} / WY \quad (1)$$

$$S = \text{フォーカス誤差の最大値} / F \quad (2)$$

【0030】 図17(a)は、スキヤン方向のレベリングの応答周波数 f_m 、及び非スキヤン方向のレベリングの応答周波数 f_n が等しく且つ大きい場合の曲がりパラメータ F に対する誤差パラメータ S を表し、曲線A1は非スキヤン方向での誤差パラメータ S 、曲線B1は非スキヤン方向の誤差パラメータ S 中の通常のフォーカス誤差の平均値の絶対値、曲線A2はスキヤン方向での誤差

パラメータ S 、曲線B2はスキヤン方向の誤差パラメータ S 中の通常のフォーカス誤差の平均値を示す。曲線A1及び曲線A2がそれぞれより現実的なフォーカス誤差を現わしている。メータ F の値が小さく露光面の凹凸の周期が小さいときには、スキヤン方向のレベリング制御の追従性は悪く(曲線A2)、凹凸の周期が大きくなるにつれて、スキヤン方向のレベリング制御が曲がりに追従するようになることが分かる。また、非スキヤン方向に対してはスキヤン方向の様に逐次フォーカス位置が変わらない為、曲がりの周期が大きくなっても、スキヤン方向の追従性より悪い(曲線A1)。以上のように、パラメータ S が0.5以下になるようにフォーカス誤差がなることが望ましいが、スキヤン方向及び非スキヤン方向共に全体としてフォーカス誤差が大きい。

【0031】 一方、図17(b)は、スキヤン方向のレベリングの応答周波数 f_m が非スキヤン方向のレベリングの応答周波数 f_n より大きく、且つ両応答周波数 f_m 及び f_n が小さい場合の曲がりパラメータ F に対する誤差パラメータ S を表し、曲線A3は非スキヤン方向での誤差パラメータ S 、曲線B3は非スキヤン方向の通常のフォーカス誤差の平均値の絶対値、曲線A4はスキヤン方向での誤差パラメータ S 、曲線B4はスキヤン方向での通常のフォーカス誤差の平均値の絶対値を示す。図17(a)と図17(b)との比較より、ほぼ完全応答(図17(a))の場合よりも応答周波数が小さい(図17(b))場合の方が、誤差パラメータ S が0.5に近くなっており、フォーカス誤差は小さいことが分かる。これは、感光基板上の細かい凹凸にオートレベリング機構が追従すると、スリット状の露光フィールド24内で精度が悪化する点が発生するためである。但し、応答周波数を小さくし過ぎると、低周波の凸凹部まで追従できなくなるため、応答周波数は適当な値に設定する必要がある。

【0032】 また、図17(b)の例では、スキヤン方向のレベリングの応答周波数 f_m が非スキヤン方向のレベリングの応答周波数 f_n より高く設定されている。これは、同じ曲がりパラメータ F の凹凸であっても、スキヤン方向ではスリット幅に応じて実質的に周期が短くなるため、良好に露光面の凹凸に追従するための応答周波数は、非スキヤン方向よりもスキヤン方向で高くする必要があるためである。

【0033】 また、オートレベリング機構用の多点計測手段が、その所定形状の照明領域と投影光学系(8)に関して共役な露光領域(24)内の複数の点及びその共役な露光領域内に対して感光基板(5)が走査される際の手前の領域内の複数の点よりなる複数の計測点において、感光基板(5)の高さをそれぞれ計測する場合に、手前の計測点において部分的にフォーカス位置の先読みが行われる。これを「分割先読み」と呼ぶ。従って、全部の計測点で先読みを行う手法(完全先読み)に

比べて、露光までに多点計測手段でフォーカス位置を読み取る際の長さ（助走距離）が短縮される。

【0034】また、その多点計測手段が、感光基板（5）の1つのショット領域へ順次マスク（12）のパターンを露光する過程において、順次それら複数の計測点の位置を変化させる場合には、例えばそのショット領域の端部では分割先読みを行い、そのショット領域の中央部以降では完全先読みを行い、露光位置検出部でオープン制御の確認を行う。これにより、レベリング精度を高精度に維持した状態で、ショット領域の端部での助走距離を短縮して露光のスループットを高めることができる。

【0035】次に、本発明の第2の面位置設定装置におけるオートフォーカス制御について検討する。上述の良好なフィールド（Good Field）の概念を取り入れると、図16に示すように、露光フィールド24の中央部24a内の各計測点のフォーカス位置の平均化処理を行って、そのフォーカス位置の平均値で示される面を投影光学系の像面に合わせるのでは、精度が悪化する可能性がある。即ち、図18（a）は、感光基板の深さHの凹部のある露光面5aの各計測点のフォーカス位置の平均値に対応する面34Aを示し、その面34Aと凹部とのフォーカス方向の差 ΔZ_3 は、 $H/2$ より大きくなっている。

【0036】これに対して本発明においては、露光面5a上の所定の計測領域内の各計測点のフォーカス位置の最大値と最小値とを求め、それら最大値と最小値との中間のフォーカス位置に対応する面を投影光学系の像面に合わせ込むようにする。図18（b）は、感光基板の深さHの凹部のある露光面5aにおける、各計測点のフォーカス位置の内の最大値 Z_{\max} と最小値 Z_{\min} との中間のフォーカス位置に対応する面34Bを示し、面34Bのフォーカス位置 Z_{34B} は次のように表すことができる。

$$Z_{34B} = (Z_{\max} + Z_{\min}) / 2 \quad (3)$$

【0037】その後、その面34Bが投影光学系の像面に合わせ込まれる。また、面34Bと露光面5aの表面とのフォーカス方向の差 ΔZ_4 と、面34Bとその凹部とのフォーカス方向の差 ΔZ_5 とは、それぞれほぼ $H/2$ になっている。即ち、図18（a）の面34Aに比べて図18（b）の面34Bの方が、露光面5a上の各点におけるフォーカス位置の誤差の最大値が小さくなるため、良好なフィールド（Good Field）の概念上では、本発明により感光基板の露光面をより高精度に投影光学系の像面に合わせ込むことができる。

【0038】更に、図17（a）のように、スキャン方向のレベリングの応答周波数 f_m と非スキャン方向のレベリングの応答周波数 f_n とを等しく且つ大きくしてオ

$$Z_{MN} = (M \cdot Z_{\max} + N \cdot Z_{\min}) / (M + N) \quad (4)$$

【0042】

ートレベリング制御を行うと同時に、図18（a）の平均化処理に基づくオートフォーカス制御又は図18

（b）の最大値と最小値との平均値に基づくオートフォーカス制御を施した場合の、曲がりパラメータFに対する誤差パラメータSの特性をそれぞれ図19（a）及び（b）に示す。即ち、平均化処理に基づく図19（a）において、曲線A5及びB5はそれぞれ非スキャン方向の誤差パラメータS、曲線A6及びB6はそれぞれスキャン方向の誤差パラメータSを表す。また、最大値と最小値との平均値に基づく図19（b）において、曲線A7及びB7はそれぞれ非スキャン方向の誤差パラメータS、曲線A8及びB8はそれぞれスキャン方向の誤差パラメータSを表す。

【0039】図19（b）より明かなように、最大値と最小値との平均値に基づいてオートフォーカス制御を施した場合には、全ての曲がりパラメータF、即ちあらゆる周波数帯において、誤差パラメータSの値が0.5に近くなっていると共に、平均化処理に基づいてオートフォーカス制御を施した場合に比べてフォーカス誤差の最大値が小さくなっている。

【0040】また、図15（a）及び（b）に戻り、所定の計測領域内の計測点で得られたフォーカス位置の最大値と最小値との平均値に基づいてオートフォーカス制御のみを施した場合には、図15（a）に示すように、振幅 $2 \cdot \Delta Z_a$ の曲がりを有する露光面5aに対して、最大値とのフォーカス位置の差が ΔZ_a の面36Aが投影光学系の像面に合わせ込まれる。一方、振幅 $2 \cdot \Delta Z_a$ の曲がりを有する露光面5aに対して、単にそれら計測点で得られたフォーカス位置の平均値に基づいてオートフォーカス制御を行うと共に、得られたフォーカス位置の最小自乗近似に基づいてオートレベリング制御を行うと、図15（b）に示すように、振幅 ΔZ_c （ $> 2 \cdot \Delta Z_a$ ）の範囲内で最大値からのフォーカス位置の差が ΔZ_b （ $> \Delta Z_a$ ）の面36Bが投影光学系の像面に合わせ込まれることがある。従って、オートレベリング機構を使用する場合でも使用しない場合でも、得られたフォーカス位置の最大値と最小値との平均値に基づいてオートフォーカス制御を行う方がフォーカス誤差が小さくなる。

【0041】なお、本発明では、（フォーカス位置の最大値 Z_{\max} + フォーカス位置の最小値 Z_{\min} ）/2で定まる面を像面に合わせ込むように制御しているが、デバイス工程によっては感光基板の露光面5aの凸部又は凹部の何れかの焦点深度が要求される場合もある。従って、所定の係数M及びNを用いて、次式のような比例配分で定まるフォーカス位置 Z_{MN} の面を像面に合わせるような制御を行うことが望ましい。

【実施例】以下、本発明の一実施例につき図面を参照し

て説明する。本実施例は、スリットスキャン露光方式の投影露光装置のオートフォーカス機構及びオートレベリング機構に本発明を適用したものである。図1は本実施例の投影露光装置を示し、この図1において、図示省略された照明光学系からの露光光E Lによる矩形の照明領域（以下、「スリット状の照明領域」という）によりレチクル12上のパターンが照明され、そのパターンの像が投影光学系8を介してウエハ5上に投影露光される。この際、露光光E Lのスリット状の照明領域に対して、レチクル12が図1の紙面に対して手前方向（又は向こう側）に一定速度Vで走査されるのに同期して、ウエハ5は図1の紙面に対して向こう側（又は手前方向）に一定速度V/ β （ $1/\beta$ は投影光学系8の縮小倍率）で走査される。

【0043】レチクル12及びウエハ5の駆動系について説明するに、レチクル支持台9上にY軸方向（図1の紙面に垂直な方向）に駆動自在なレチクルY駆動ステージ10が載置され、このレチクルY駆動ステージ10上にレチクル微小駆動ステージ11が載置され、レチクル微小駆動ステージ11上にレチクル12が真空チャック等により保持されている。レチクル微小駆動ステージ11は、投影光学系8の光軸に垂直な面内で図1の紙面に平行なX方向、Y方向及び回転方向（ θ 方向）にそれぞれ微小量だけ且つ高精度にレチクル12の位置制御を行う。レチクル微小駆動ステージ11上には移動鏡21が配置され、レチクル支持台9上に配置された干渉計14によって、常時レチクル微小駆動ステージ11のX方向、Y方向及び θ 方向の位置がモニターされている。干渉計14により得られた位置情報S1が主制御系22Aに供給されている。

【0044】一方、ウエハ支持台1上には、Y軸方向に駆動自在なウエハY軸駆動ステージ2が載置され、その上にX軸方向に駆動自在なウエハX軸駆動ステージ3が載置され、その上にZレベリングステージ4が設けられ、このZレベリングステージ4上にウエハ5が真空吸着によって保持されている。Zレベリングステージ4上にも移動鏡7が固定され、外部に配置された干渉計13により、Zレベリングステージ4のX方向、Y方向及び θ 方向の位置がモニターされ、干渉計13により得られた位置情報も主制御系22Aに供給されている。主制御系22Aは、ウエハ駆動装置22B等を介してウエハY軸駆動ステージ2、ウエハX軸駆動ステージ3及びZレベリングステージ4の位置決め動作を制御すると共に、装置全体の動作を制御する。

【0045】また、ウエハ側の干渉計13によって計測される座標により規定されるウエハ座標系と、レチクル側の干渉計14によって計測される座標により規定されるレチクル座標系の対応をとるために、Zレベリングステージ4上のウエハ5の近傍に基準マーク板6が固定されている。この基準マーク板6上には各種基準マークが

形成されている。これらの基準マークの中にはZレベリングステージ4側に導かれた照明光により裏側から照明されている基準マーク、即ち発光性の基準マークも設けられている。

【0046】本例のレチクル12の上方には、基準マーク板6上の基準マークとレチクル12上のマークとを同時に観察するためのレチクルアライメント顕微鏡19及び20が装備されている。この場合、レチクル12からの検出光をそれぞれレチクルアライメント顕微鏡19及び20に導くための偏向ミラー15及び16が移動自在に配置され、露光シーケンスが開始されると、主制御系22Aからの指令のもとで、ミラー駆動装置17及び18によりそれぞれ偏向ミラー15及び16は待避される。

【0047】図1のスリットスキャン方式の投影露光装置に、図20及び図21を参照して説明した従来方式の斜め入射型の多点フォーカス位置検出系を装着する。但し、本例の多点フォーカス位置検出系は、計測点の個数が従来例よりも多いと共に、計測点の配置が工夫されている。図2（b）は、図21（b）の従来のパターン形成板62に対応する本例のパターン形成板62Aを示し、図2（b）に示すように、パターン形成板62Aの第1列目には9個のスリット状の開孔パターン72-11～72-19が形成され、第2列目～第5列目にもそれぞれ9個の開孔パターン72-12～72-59が形成されている。即ち、パターン形成板62Aには、合計で45個のスリット状の開孔パターンが形成されており、これらのスリット状の開孔パターンの像が図1のウエハ5の露光面上にX軸及びY軸に対して斜めに投影される。

【0048】図2（a）は、本例の投影光学系8の下方のウエハ5の露光面を示し、この図2（a）において、投影光学系8の円形の照明視野23に内接するX方向に長い矩形の露光フィールド24内に図1のレチクル12のパターンが露光され、この露光フィールド24に対してY方向にウエハ5が走査（スキャン）される。本例の多点フォーカス位置検出系により、露光フィールド24のY方向の上側のX方向に伸びた第1列の9個の計測点AF11～AF19、第2列の計測点AF21～AF29、露光フィールド24内の第3列の計測点AF31～AF39、露光フィールド24のY方向の下側の第4列の計測点AF41～AF49及び第5列の計測点AF51～AF59にそれぞれスリット状の開孔パターンの像が投影される。

【0049】図2（c）は、本例の多点フォーカス位置検出系の受光器69Aを示し、この受光器69A上に第1列目には9個の受光素子75-11～75-19が配置され、第2列目～第5列目にもそれぞれ9個の受光素子75-12～75-59が配置されている。即ち、受光器69Aには、合計で45個の受光素子が配列されて

おり、各受光素子上にはスリット状の絞り（図示省略）が配置されている。また、それら受光素子75-11~75-59上にそれぞれ図2(a)の計測点AF11~AF59に投影されたスリット状の開口パターン像が再結像される。そして、ウエハ5の露光面で反射された光を、図20の回転方向振動板67に対応する振動板で回転振動することで、受光器69A上では再結像された各像の位置が絞りの幅方向であるRD方向に振動する。

【0050】各受光素子75-11~75-59の検出信号が信号処理装置71Aに供給され、信号処理装置71Aではそれぞれの検出信号を回転振動周波数の信号で同期検波することにより、ウエハ上の各計測点AF11~AF59のフォーカス位置に対応する45個のフォーカス信号を生成し、これら45個のフォーカス信号の内の所定のフォーカス信号より後述のように、ウエハの露光面の傾斜角（レベリング角）及び平均的なフォーカス位置を算出する。これら計測されたレベリング角及びフォーカス位置は図1の主制御系22Aに供給され、主制御系22Aは、その供給されたレベリング角及びフォーカス位置に基づいて駆動装置22B及びZレベリングステージ4を介してウエハ5のレベリング角及びフォーカス位置の設定を行う。

【0051】従って、本例では図2(a)に示す45個の全ての計測点AF11~AF59のフォーカス位置を計測することができる。但し、本例では、図3に示すように、ウエハのスキャン方向に応じてそれら45個の計測点中で実際にフォーカス位置を計測する点（以下、「サンプル点」という）の位置を変えている。一例として、図3(a)に示すように、露光フィールド24に対してY方向にウエハをスキャンする場合で、且つ後述のような分割先読みを行う場合には、第2列25Bの計測点中の奇数番目の計測点AF21, AF23, ..., AF29及び露光フィールド24内の偶数番目の計測点AF32, AF34, ..., AF38がサンプル点となる。また、図3(b)に示すように、露光フィールド24に対して-Y方向にウエハをスキャンする場合で、且つ後述のような分割先読みを行う場合には、第4列25Dの計測点中の奇数番目の計測点AF41, AF43, ..., AF49及び露光フィールド24内の偶数番目の計測点AF32, AF34, ..., AF38がサンプル点となる。

【0052】更に、スリットスキャン露光時のフォーカス位置の計測結果は、ウエハ側のステージの移動座標に応じて逐次変化していくため、それらフォーカス位置の計測結果は、ステージのスキャン方向の座標及び非スキャン方向の計測点の座標よりなる2次元のマップとして図1の主制御系22A内の記憶装置に記憶される。このように記憶された計測結果を用いて、露光時のウエハのフォーカス位置及びレベリング角が算出される。そして、実際に図1のZレベリングステージ4を駆動してウ

エハの露光面のフォーカス位置及びレベリング角を設定する場合は、計測結果に従ってオープンループ制御によりZレベリングステージ4の動作が制御される。この場合、予め計測された結果に基づいて露光フィールド24内での露光が行われる。即ち、図4(a)に示すように、例えば第2列25Bの計測点の所定のサンプリング点でウエハ上の領域26のフォーカス位置の計測が行われ、その後図4(b)に示すようにウエハ上の領域26が露光フィールド24内に達したときに、図4(a)での計測結果に基づいて、ウエハ上の領域26のフォーカシング及びレベリング制御が行われる。

【0053】図5は本例のZレベリングステージ4及びこの制御系を示し、この図5において、Zレベリングステージ4の上面部材は下面部材上に3個の支点28A~28Cを介して支持されており、各支点28A~28Cはそれぞれフォーカス方向に伸縮できるようになっている。各支点28A~28Cの伸縮量を調整することにより、Zレベリングステージ4上のウエハ5の露光面のフォーカス位置、スキャン方向の傾斜角 θ_y 及び非スキャン方向の傾斜角 θ_x を所望の値に設定することができる。各支点28A~28Cの近傍にはそれぞれ、各支点のフォーカス方向の変位量を例えば0.01 μ m程度の分解能で計測できる高さセンサー29A~29Cが取り付けられている。なお、フォーカス方向（Z方向）への位置決め機構として、よりストロークの長い高精度な機構を別に設けても良い。

【0054】Zレベリングステージ4のレベリング動作を制御するために、主制御系22Aはフィルタ部30A及び30Bにそれぞれ刻々に変化する非スキャン方向の設定すべき傾斜角 θ_x 及びスキャン方向の設定すべき傾斜角 θ_y を供給する。フィルタ部30A及び30Bはそれぞれ異なるフィルタ特性でフィルタリングして得られた傾斜角を演算部31に供給し、主制御系22Aは演算部31にはウエハ5上の露光対象とする領域の座標W

(X, Y)を供給する。演算部31は、座標W(X, Y)及び2つの傾斜角に基づいて駆動部32A~32Cに設定すべき変位量の情報を供給する。各駆動部32A~32Cにはそれぞれ高さセンサー29A~29Cから支点29A~29Cの現在の高さの情報も供給され、各駆動部32A~32Cはそれぞれ支点29A~29Cの高さを演算部31に設定された高さに設定する。

【0055】これにより、ウエハ5の露光面のスキャン方向の傾斜角及び非スキャン方向の傾斜角がそれぞれ所望の値に設定されるが、この際にフィルタ部30A及び30Bの特性の相違により、スキャン方向のレベリングの応答周波数 f_m [Hz]が非スキャン方向のレベリングの応答速度 f_n [Hz]よりも高めに設定されている。一例としてスキャン方向のレベリングの応答周波数 f_m は10Hz、非スキャン方向のレベリングの応答速度 f_n は2Hzである。

【0056】また、支点28A、28B及び28Cが配置されている位置をそれぞれ駆動点TL1、TL2及びTL3と呼ぶと、駆動点TL1及びTL2はY軸に平行な直線上に配置され、駆動点TL3は駆動点TL1とTL2との垂直二等分線上に位置している。そして、投影光学系によるスリット状の露光フィールド24が、ウエハ5上のショット領域SA_{1j}上に位置しているものとする、本例では、支点28A～28Cを介してウエハ5のレベリング制御を行う際に、そのショット領域SA_{1j}のフォーカス位置は変化しない。従って、レベリング制御とフォーカス制御とが分離した形で行われるようになっている。また、ウエハ5の露光面のフォーカス位置の設定は、3個の支点28A～28Cを同じ量だけ変位させることにより行われる。

$$SX = \sum_m X_m, \quad SX^2 = \sum_m X_m^2, \quad SMZ = \sum_m AF(X_m, Y_n), \\ SXZ = \sum_m (AF(X_m, Y_n) \cdot X_m) \quad (5)$$

同様に、和演算 Σ_n が添字nに関する1～Nまでの和を表すものとして、次の演算を行う。

$$SY = \sum_n Y_n, \quad SY^2 = \sum_n Y_n^2, \quad SNZ = \sum_n AF(X_m, Y_n), \\ SYZ = \sum_n (AF(X_m, Y_n) \cdot Y_n) \quad (6)$$

【0059】そして、(5)式及び(6)式を用いて次の演算を行う。

$$An = (SX \cdot SMZ - M \cdot SXZ) / (SX^2 - M \cdot SX^2) \quad (7)$$

$$Am = (SY \cdot SNZ - N \cdot SYZ) / (SY^2 - N \cdot SY^2) \quad (8)$$

次に、各Anより、最小自乗近似によりスキヤン方向のn番目のサンプル点における非スキヤン方向(X方向)の傾斜角AL(Y_n)を求め、各Amより、最小自乗近似により非スキヤン方向のm番目のサンプル点におけるスキヤン方向(Y方向)の傾斜角AL(X_m)を求める。その後、次のような平均化処理により非スキヤン方向の傾斜角 θ_x 及びスキヤン方向の傾斜角 θ_y を求める。

$$\theta_x = (\sum_n AL(Y_n)) / N \quad (9)$$

$$\langle AF \rangle = (\sum_n \sum_m AF(X_m, Y_n)) / (M \cdot N) \quad (11)$$

【0061】次に、最大最小検出法では、最大値及び最小値を表す関数をそれぞれMax()及びMin()とし

$$AF' = (\text{Max}(AF(X_m, Y_n)) + \text{Min}(AF(X_m, Y_n))) / 2 \quad (12)$$

そして、図4(b)に示すように、計測された領域26が露光フィールド24に達したときには、(9)式、

(10)式、(12)式の検出結果 θ_x 、 θ_y 及びAF'に基づいて、図5の3個の支点28A～28Cがそれぞれ高さセンサー29A～29Cの計測結果を基準としてオープンループで駆動される。具体的に、オートフォーカス制御は、3個の支点28A～28Cを同時に駆動することにより実行され、オートレベリング制御は、図5に示す露光フィールド24内のフォーカス位置が変化しないように実行される。

【0062】即ち、図5において、露光フィールド24の中心点と支点28A、28BのX方向の間隔をX₁、露光フィールド24の中心点と支点28CのX方向の間隔をX₂、露光フィールド24の中心点と支点28AのY方向の間隔をY₁、露光フィールド24の中心点と支

【0057】次に、本例のレベリング動作及びフォーカシング動作につき詳細に説明する。まず、レベリング用の傾斜角及びフォーカシング用のフォーカス位置の算出法を示す。

(A) 傾斜角の算出法

図4に示すように、各列の計測点において非スキヤン方向のm番目のサンプル点のX座標をX_m、スキヤン方向のn番目のサンプル点のY座標をY_nとして、X座標X_m及びY座標Y_nのサンプル点で計測されたフォーカス位置の値をAF(X_m, Y_n)で表す。また、非スキヤン方向のサンプル数をM、スキヤン方向のサンプリング数をNとして、次の演算を行う。但し、和演算 Σ_m は添字mに関する1～Mまでの和を表す。

【0058】

$$SX = \sum_m X_m, \quad SX^2 = \sum_m X_m^2, \quad SMZ = \sum_m AF(X_m, Y_n), \\ SXZ = \sum_m (AF(X_m, Y_n) \cdot X_m) \quad (5)$$

表すものとして、次の演算を行う。

$$SY = \sum_n Y_n, \quad SY^2 = \sum_n Y_n^2, \quad SNZ = \sum_n AF(X_m, Y_n), \\ SYZ = \sum_n (AF(X_m, Y_n) \cdot Y_n) \quad (6)$$

の演算を行う。

$$An = (SX \cdot SMZ - M \cdot SXZ) / (SX^2 - M \cdot SX^2) \quad (7)$$

$$Am = (SY \cdot SNZ - N \cdot SYZ) / (SY^2 - N \cdot SY^2) \quad (8)$$

$$\theta_y = (\sum_m AL(X_m)) \quad (10)$$

【0060】(B) フォーカス位置算出法

フォーカス位置の算出法には平均化処理法と最大最小検出法とがあり、本例では最大最小検出法でフォーカス位置を算出する。参考のため、平均化処理法では、上述のフォーカス位置の値AF(X_m, Y_n)を用いて、次式よりウエハ5の露光面の全体としてのフォーカス位置<AF>を計算する。

て、次式よりウエハ5の露光面の全体としてのフォーカス位置AF'を計算する。

$$AF' = (\text{Max}(AF(X_m, Y_n)) + \text{Min}(AF(X_m, Y_n))) / 2 \quad (12)$$

点28BのY方向の間隔をY₂として、非スキヤン方向の傾斜角 θ_x の結果に基づき、支点28A、28Bと支点28CとにそれぞれX₁:X₂との比で逆方向の変位が与えられ、スキヤン方向の傾斜角 θ_y の結果に基づき、支点28Aと支点28BとにそれぞれY₁:Y₂との比で逆方向の変位が与えられる。

【0063】また、上記処理法では、フォーカス位置及び傾斜角が露光装置に応じて刻々変化するので実際のフォーカス位置の計測値を補正する必要がある。図6

(a)は、或るフォーカス位置の計測点(AF点)でウエハの露光面5a上の領域26の全体としてのフォーカス位置及び傾斜角を計測している状態を示し、図6

(a)の状態では、図5の各駆動点TL1～TL3にある支点のフォーカス方向の駆動量<TL1>、<TL2>及び<TL3>はそれぞれ0(基準位置)であると

する。そして、その領域26が図6(b)に示すように、露光フィールド内の露光点に達したときには、露光のためにそれら駆動量はそれぞれ、 $\langle TL1 \rangle = a$ 、 $\langle TL2 \rangle = b$ 、 $\langle TL3 \rangle = c$ 、に設定される。この場合、フォーカス位置の計測点(AF点)で計測されている領域26Aのフォーカス位置は、図6(a)の場合に比べて ΔF だけ変化しているが、この ΔF の変化量には各駆動点TL1~TL3における駆動量の影響が含まれているため、次に領域26Aの露光を行う場合には、図6(b)の状態での各駆動点TL1~TL3の駆動量を補正する形でレベリング及びフォーカシングを行う必要がある。

【0064】即ち、領域26に関して計測されたフォーカス位置、X方向の傾斜角及びY方向の傾斜角をそれぞれ F_1 、 θ_{1x} 及び θ_{1y} として、領域26Aに関して計測されたフォーカス位置、X方向の傾斜角及びY方向の傾斜角をそれぞれ F_n' 、 θ_{nx}' 及び θ_{ny}' とする。また、フォーカス位置の計測点(AF点)と露光点とのX方向及びY方向の間隔をそれぞれ ΔX 及び ΔY とすると、フォーカス位置の補正量 $\Delta F1$ は次のようになる。

$$\Delta F1 = -F_1 - \theta_{1x} \cdot \Delta X - \theta_{1y} \cdot \Delta Y \quad (13)$$

【0065】その補正量 $\Delta F1$ を用いると、領域26Aに関して計測されたフォーカス位置、X方向の傾斜角及びY方向の傾斜角のそれぞれの補正後の値 F_n 、 θ_{nx} 及び θ_{ny} は次のようになる。

$$F_n = F_n' + \Delta F1 \quad (14)$$

$$\theta_{nx} = \theta_{nx}' - \theta_{1x} \quad (15)$$

$$f = (V/\beta) / L_0 \cdot (L_0/p) = (V/\beta) / p \quad (18)$$

従って、走査速度 V/β が変化すると周波数 f も変化するので、最適な応答周波数 ν を新たに求める必要がある。このようにして求めた応答周波数 ν よりサーボゲインを決定する。

【0068】(D) 数値フィルタリング法

ここでウエハの露光面上の凹凸のピッチ p は、ステージ位置に依存した関数なので、フォーカス位置のサンプリングをステージ位置に同期して位置基準で行うと、走査速度 V/β に依存しない制御が可能になる。即ち、位置関数で伝達関数 $G(s)$ と同等のフィルタリング効果を持たせるためには、伝達関数 $G(s)$ を逆フーリエ変換して位置関数 $F(x)$ を求め、この位置関数 $F(x)$ を用いて数値フィルタリングを行う。具体的に応答周波数 ν の伝達関数 $G(s)$ の一例を図7(a)に示し、それに対応する位置関数 $F(x)$ を図7(b)に示す。但し、数値フィルタリング時は助走スキャン距離をとる必要があり、これを行わない場合は位相遅れが生じる。

【0069】なお、上述のサーボゲイン可変法及び数値フィルタリング法の内の何れの方法においても、位相遅れとフィルタリング効果とで応答性を管理する。位相遅れ(時間遅れ)とは、図15(c)の曲線37Aで示される目標とするフォーカス位置に対応する信号と、曲線

$$\theta_{ny} = \theta_{ny}' - \theta_{1y} \quad (16)$$

また、ウエハ5の露光面の高周波の凸凹面に対しては追従しない様に応答性を管理する必要がある。即ち、ウエハ5の走査速度が変わった場合も、ステージ位置に対応した応答が要求されるので、計測されたフォーカス位置及び傾斜角を高速フーリエ変換(FFT)用の数値フィルタで管理するか、図5の3個の支点28A~28Cの駆動部のサーボゲインを速度に応じて可変できる機構にする。但し、FFT用の数値フィルタは予備スキャンが必要で、サーボゲインは位相遅れがあるので、これらを考慮した機構が必要である。

【0066】(C) サーボゲイン可変法

ここでは図5の3個の支点28A~28Cの駆動部のサーボゲインを速度に応じて可変する方法の一例につき説明する。ウエハの走査速度が V/β のときの応答周波数を ν とすると、伝達関数 $G(s)$ は以下の様に表される。

$$G(s) = 1 / (1 + Ts) \quad (17)$$

但し、 $T = 1 / (2\pi\nu)$ 、 $s = 2\pi f i$ 、である。

【0067】解析結果より、走査速度 V/β が80mm/sの場合、非スキャン方向の応答周波数 ν は2Hzが最適で、スキャン方向の応答周波数 ν は10Hzが最適であることが分かった。但し、ウエハの露光面の凸凹をピッチ p の正弦波で表し、ウエハ上の各ショット領域の走査方向の長さを L_0 とすると、(17)式中の周波数 f は次のようになる。

38Aで示される実際に計測されたフォーカス位置に対応する信号との間に存在する時間遅れである。フィルタリング効果とは、図15(d)の曲線37B及び38Bで示すように、目標とするフォーカス位置に対して実際のフォーカス位置の振幅を所定量だけ小さくすることである。

【0070】上述のように、本例ではウエハの各ショット領域への露光を行う際に、予備的な走査である助走スキャンを行う場合がある。そこで、その助走スキャン距離の設定方法について説明する。図8(a)は、ウエハ上のショット領域 SA_{11} の露光が終わってから、順次隣りのショット領域 SA_{12} 及び SA_{13} へレチクルのパターンを露光する場合の走査方法を示す。この図8(a)において、ウエハを-Y方向に走査して、ウエハ上のショット領域 SA_{11} への露光が終わってから、加減速期間 T_{w1} の間にウエハをX軸及びY軸に対して斜めに移動させて、次のショット領域 SA_{12} の下端の近傍を投影光学系の露光フィールドに配置する。最初のショット領域 SA_{11} への露光が終わってから、次のショット領域 SA_{12} の下端の近傍へ移動する間にY方向へ間隔 ΔL の移動が行われる。また、その加減速期間 T_{w1} の終期において、ウエハのY方向への移動が開始される。

【0071】その後の制定（整定）期間 T_{w2} の間に、ウエハの走査速度がほぼ V/β に達し、それに続く露光期間 T_{w3} の間にショット領域 SA_{12} へのレチクルのパターンの露光が行われる。この場合の、ウエハ側での加減速期間 T_{w1} 、制定期間 T_{w2} 及び露光期間 T_{w3} を図8（c）に示し、レチクル側での加減速期間 T_{R1} 、制定期間 T_{R2} 及び露光期間 T_{R3} を図8（b）に示す。なお、レチクル側では図8（a）のように隣りのショット領域へ移動する必要がないため、レチクル側のステージの移動はY軸に沿う往復運動である。また、ウエハ側では、図8（c）に示すように、加減速期間 T_{w1} から制定期間 T_{w2} へ移行する程度の時点 t_0 から、多点フォーカス位置検出系によるフォーカス位置のサンプリングが開始される。

【0072】本例では位相遅れとフィルタリング効果とで、レベリング及びフォーカシング時の応答性を管理するので、ウエハ上でフォーカス位置のサンプリングを開始するときの開始点が、状況によって異なってくる。例えば、サンプリングをステージ位置に同期させるものとして、数値フィルタリングを行うとすると、次の手順でサンプリング開始位置が決定される。

【0073】まず、図7（a）のように伝達関数 $G(s)$ が与えられ、この伝達関数 $G(s)$ より逆フーリエ変換で図7（b）の位置関数 $F(x)$ を求め、この位置関数 $F(x)$ の原点からゼロクロス点までの長さ ΔL を求める。この長さ ΔL が、図8（a）に示すように、隣りのショット領域 SA_{12} への露光のために斜めに移動する際のY方向への移動量 ΔL と等しい。

【0074】また、レチクルの加減速期間 T_{R1} に対して、ウエハの加減速期間 T_{w1} が小さいため、時間 $(T_{R1} - T_{w1})$ はウエハ側の待ち時間となる。この場合、 $\Delta L < (V/\beta)(T_{R1} - T_{w1})$ 、のときはスループットの低下にならないが、 $\Delta L > (V/\beta)(T_{R1} - T_{w1})$ 、のときはスループットの低下となる。なお、 $\Delta Y = \Delta L - (V/\beta)(T_{R1} - T_{w1})$ 、で表される長さ ΔY は位相遅れとして処理しても、伝達関数 $G(s)$ と同様のフィルタリング効果が得られれば、固定関数として良い。これらのフィルタリングを行うことにより、多点フォーカス位置検出系に対する空気揺らぎや、多点フォーカス位置検出系の制御誤差の影響を低減する効果も期待できる。

【0075】次に、本例のスリットスキャン露光方式の投影露光装置における、多点フォーカス位置検出系の計測点中のサンプル点の配置を検討する。まず、図2

（a）において、多点フォーカス位置検出系による計測点AF11～AF59の内で、スリット状の露光フィールド24内の計測点AF31～AF39のフォーカス位置の計測結果を用いる場合、即ち計測点AF31～AF39をサンプル点とする場合には、従来のステッパーの場合と同様の「露光位置制御法」による制御が行われ

る。更に、本例のウエハのスキャンはY方向又は-Y方向へ行われるので、露光フィールド24に対して走査方向の手前に計測点中のサンプル点を配置することで、先読み制御、時分割レベリング計測、及び計測値平均化等が可能になる。

【0076】先読み制御とは、図2（a）にのようなウエハを露光フィールド24に対して-Y方向にスキャンする場合には、走査の手前の計測点AF41～AF49、AF51～AF59中からもサンプル点を選択することを意味する。先読み制御を行うことにより、オートフォーカス機構及びオートレベリング機構の伝達関数 $G(s)$ に対して、実際の応答周波数に対する追従誤差は $|1 - G(s)|$ となる。但し、この追従誤差には位相遅れとフィルタリング誤差要因が入っているため、先読み制御を行えば、位相遅れを除去できることになる。この誤差は $1 - |G(s)|$ なので、約4倍の伝達能力を持たせる事が出来る。

【0077】図9（a）は従来と同様の露光位置制御を行った場合の目標とするフォーカス位置に対応する曲線39A及び実際に設定されたフォーカス位置に対応する曲線38Bを示し、図9（b）は先読み制御を行った場合の目標とするフォーカス位置に対応する曲線40A及び実際に設定されたフォーカス位置に対応する曲線40Bを示し、露光位置制御では位相がずれている。従って、露光位置制御の場合の目標位置と追従位置との差 F_a は、先読み制御の場合の目標位置と追従位置との差 F_b の約4倍となる。従って、先読み制御では約4倍の伝達能力をもたせることができる。

【0078】しかし、既に述べた様に、オートレベリングの応答周波数はスキャン方向で10Hz程度が適当（位置制御法では）なので、先読み制御を行うと、スキャン方向では2.5Hz程度のフィルタリング応答が良いことになる。このフィルタリングを数値フィルタ又は制御ゲインによって行うと、ウエハの走査速度を80mmとして、5（ $\approx 80/(2\pi \cdot 2.5)$ ）mm程度の助走スキャン長が、露光前に必要になる。以下に両制御法による、フォーカス誤差を示す。

【0079】そのため、図17の場合と同様に、ウエハ上のショット領域 SA_{12} のスキャン方向の周期的な曲がりの周期を、スキャン方向の幅との比の値として曲がりパラメータFで表し、その周期的な曲がりがあるときの各計測点でのフォーカス誤差を、各計測点でのフォーカス位置の誤差の平均値の絶対値と、フォーカス位置の誤差の振幅の1/3との和で表す。また、曲がりパラメータFの周期的な曲がりの振幅を1に規格化し、曲がりパラメータがFであるときの、それら各計測点でのフォーカス誤差の内の最大値を示す誤差パラメータSを、曲がりパラメータFに対する比率として表す。

【0080】図10（a）は、露光位置制御を行った場合で、且つスキャン方向のレベリングの応答周波数f m

が10Hz、非スキャン方向のレベリングの応答周波数 f_n が2Hzの場合の曲がりパラメータFに対する誤差パラメータSを表し、曲線A9及びB9は共に非スキャン方向での誤差パラメータS、曲線A10及びB10は共にスキャン方向での誤差パラメータSを示す。一方、図17(b)は、先読み制御を行った場合で、且つスキャン方向のレベリングの応答周波数 f_m が2.5Hz、非スキャン方向のレベリングの応答周波数 f_n が0.5Hzの場合の曲がりパラメータFに対する誤差パラメータSを表し、曲線A11及びB11は共に非スキャン方向での誤差パラメータS、曲線A12及びB12は共にスキャン方向での誤差パラメータSを示す。

【0081】以上の様に先読み制御で位相遅れを除去することは、応答を向上するためには良いが、応答を低下させる場合には適さない。しかし、先読み制御はソフトウェア的に自由度が多く、図11で示すような時間的平均化及び露光開始時のフォーカス位置の計測点の予測設定を行うこともできる。即ち、図11(a)において、ウエハの露光面5a上の或る領域26Bに対して多点フォーカス位置検出系の走査方向に対して手前のサンプル点(AF点)において、幅 ΔL の長さだけフォーカス位置が検出される。そして、図11(b)に示すように、領域26Bが露光点に達したときには、幅 ΔL の範囲で検出されたフォーカス位置の情報を平均化して高精度にレベリング及びフォーカシングが行われる。

【0082】また、図11(c)に示すように、露光位置制御法で計測点と露光点とが等しい場合で、ウエハの露光面5aに段差部26Cがあっても、図11(d)に示すように、フォーカス対象とする面(フォーカス面)AFPは次第に上昇するだけで、その段差部26Cではデフォーカスされた状態で露光が行われる。これに対して、図11(e)に示すように、先読み制御法で計測点と露光点とが離れている場合で、ウエハの露光面5aに段差部26Dがあると、予めその段差に合わせて図11(f)に示すように、フォーカス面AFPを次第に上昇することにより、その段差部26Dでは合焦された状態で露光が行われる。

【0083】なお、先読み制御法のみならず、通常の露光位置制御法も備えておき、2つの制御法を選択可能なシステムにすることが望ましい。本例のオートフォーカス及びオートレベリング機構には、上述のような機能があるので、実際にウエハの露光面の制御を行うには、①露光位置制御、②完全先読み制御、③分割先読み制御よりなる3種類の制御法が考えられる。以下ではこれら3種類の制御法につき詳細に説明する。

(F) 露光位置制御法

この方式ではオートフォーカス及びオートレベリング機構の応答性能を一切考慮せず、露光時に計測して得られたフォーカス位置の値を用いて、ウエハの露光面のフォーカス位置及びレベリング角の制御を行う。即ち、図1

2(a)に示すように、露光フィールド24に対して走査方向(Y方向)に手前側の第2列25Bの偶数番目の計測点をサンプル点41として、露光フィールド24内の第3列25Cの奇数番目の計測点をもサンプル点とする。そして、第2列25Bのサンプル点でのフォーカス位置の計測値と第3列25Cのサンプル点でのフォーカス位置の計測値とから、ウエハの露光面のスキャン方向のレベリング制御を行う。

【0084】また、第2列25B及び第3列25Cのサンプル点でのフォーカス位置の計測値から最小自乗近似法で非スキャン方向の傾きを求めて、非スキャン方向のレベリング制御を行う。また、フォーカス制御は、露光フィールド24内の第3列の計測点でのフォーカス位置の計測値も用いてフォーカス制御を行う。なお、図12(b)に示すように、ウエハのサンプル点は第3列25C及び第4列25Dの計測点から選択される。この方式では、最も制御が簡単であるが、ウエハのスキャン速度等により追従精度が変わってしまうという不都合がある。また、第2列25B及び第3列25Cの各計測点でのフォーカス位置のキャリブレーションが必要である。

【0085】(G) 完全先読み制御法

この方式では、図12(c)に示すように、露光フィールド24に対して走査方向に手前側の第1列25Aの全ての計測点をサンプル点として、予め露光前に第1列25Aのサンプル点でのフォーカス位置の値を全て計測しておく。そして、平均化処理やフィルタリング処理を行い、位相遅れを見込んで露光時にオープンでオートフォーカス及びオートレベリング機構を制御する。即ち、第1列25Aの各サンプル点でのフォーカス位置の計測値を記憶しておき、時間軸上で計測されたフォーカス位置の値からスキャン方向の傾きを算出し、露光時にスキャン方向のレベリング制御をオープン制御で行う。

【0086】それと並行して、第1列25Aの各サンプル点でのフォーカス位置の計測値から最小自乗近似法で非スキャン方向の傾きを求め、非スキャン方向のレベリング制御をオープン制御で行う。先読みなので、時間軸での平均化も可能である。また、第1列25Aの各サンプル点でのフォーカス位置の計測値を記憶しておき、露光時にフォーカス合わせをオープン制御で行う。なお、図12(d)に示すように、ウエハの走査方向が-Y方向の場合には、第5列25Eの全ての計測点がサンプル点として選択される。

【0087】この方式では、第1列25Aにおいてサンプル点が9点確保できるため、情報量が多く精度向上が期待できる。また、サンプル点は1ラインなのでキャリブレーションが不要である共に、応答性の管理ができるという利点がある。一方、第1列25Aのサンプル点に関してともに計測を行うと、各ショット領域の端部の露光を行うために走査すべき距離(助走スキャン長)が

長くなり、スループットが低下する不都合がある。また、オープン制御なので、多点フォーカス位置検出系による確認ができないという不都合もある。

【0088】(H) 分割先読み制御法

この方式では、図12(e)に示すように、露光フィールド24に対して走査方向(Y方向)に手前側の第2列25Bの奇数番目の計測点をサンプル点として、露光フィールド24内の第3列25Cの偶数番目の計測点をもサンプル点とする。そして、第2列25B及び第3列25Cのサンプル点において、予め露光前にフォーカス位置の値を全て計測しておく。その後、平均化処理やフィルタリング処理を行い、位相遅れを見込んで露光時にオープン制御で制御を行う。即ち、第2列25B及び第3列25Cのサンプル点におけるフォーカス位置の計測値を記憶しておき、時間軸上で計測されたフォーカス位置の値からスキャン方向の傾きを算出し、露光時にスキャン方向のレベリングをオープン制御で行う。

【0089】また、第2列25B及び第3列25Cのサンプル点におけるフォーカス位置の計測値から最小自乗近似法で非スキャン方向の傾きを求め、非スキャン方向のレベリングをオープン制御で行う。先読みなので、時間軸での平均化も可能である。また、第2列25B及び第3列25Cのサンプル点におけるフォーカス位置の計測値を記憶しておき、露光時にフォーカス合わせをオープン制御で行う。なお、図12(f)に示すように、ウエハのスキャン方向が-Y方向である場合には、サンプル点は第3列25C及び第4列25Dの計測点から選択される。

【0090】この方式では、第2列25B(又は第4列25D)が露光フィールド24に近接しているため、ウエハの各ショット領域の端部の露光を行うための助走スキャン距離を少なくできると共に、応答性の管理ができるという利点がある。また、露光時の第3列25Cのサンプル点でのフォーカス位置の計測値から、オープン制御で露光面の制御を行った結果の確認が可能である。一方、第2列25Bのサンプル点でのフォーカス位置と第3列のサンプル点でのフォーカス位置とのキャリブレーションが必要であるという不都合がある。

【0091】また、完全先読み制御法では、図13

(a)～(d)に示すように、露光開始、露光中及び露光終了間際のフォーカス位置のサンプル点を変えることによって、より正確なオートフォーカス及びオートレベリング制御を行っている。即ち、図13(a)に示すように、露光すべきショット領域SAが露光フィールド24に対して間隔D(露光フィールド24のスキヤン方向の幅と同じ)の位置に達したときに、露光フィールド24から間隔Dのサンプル領域42で多点フォーカス位置検出系によるフォーカス位置の計測が開始される。幅D、即ち露光フィールド24のスキヤン方向の幅の一例は8mmである。その後、図13(b)に示すように、

ショット領域SAの先端部が露光フィールド24に接触したときに、ウエハ上の2個のサンプル点間の検出域44でのフォーカス位置の計測値に基づいてスキヤン方向のレベリング制御が行われ、1個のサンプル点よりなる検出域45でのフォーカス位置の計測値に基づいてオートフォーカス制御が行われる。

【0092】次に、図13(c)に示すように、ショット領域SAの先端部が露光フィールド24に入ったときに、ウエハ上の2個のサンプル点間の検出域44でのフォーカス位置の計測値に基づいてスキヤン方向のレベリング制御が行われ、2個のサンプル点間の検出域45でのフォーカス位置の計測値に基づいてオートフォーカス制御が行われる。また、図13(d)に示すように、ショット領域SAが露光フィールド24を覆うようになったときには、露光フィールド24を覆う検出域44でのフォーカス位置の計測値に基づいてスキヤン方向のレベリング制御が行われ、露光フィールド24を覆う検出域45でのフォーカス位置の計測値に基づいてオートフォーカス制御が行われる。

【0093】一方、分割先読み制御法でも、図13

(e)～(h)に示すように、露光開始、露光中及び露光終了間際のフォーカス位置のサンプル点を変えることによって、より正確なオートフォーカス及びオートレベリング制御を行っている。即ち、図13(e)に示すように、露光すべきショット領域SAが露光フィールド24に対して間隔D/2(露光フィールド24のスキヤン方向の幅の1/2)の位置に達したときに、露光フィールド24から外側に間隔D/2のサンプル領域43A及び露光フィールド24から内側に間隔D/2のサンプル領域43Bで多点フォーカス位置検出系によるフォーカス位置の計測が開始される。その後、図13(f)に示すように、ショット領域SAの先端部が露光フィールド24に接触したときに、露光フィールド24を覆う検出域46でのフォーカス位置の計測値に基づいてスキヤン方向のレベリング制御が行われ、1個のサンプル点よりなる検出域47でのフォーカス位置の計測値に基づいてオートフォーカス制御が行われる。

【0094】次に、図13(g)に示すように、ショット領域SAの先端部が露光フィールド24に幅D/2だけ入ったときに、露光フィールド24を覆う検出域46でのフォーカス位置の計測値に基づいてスキヤン方向のレベリング制御が行われ、幅D/2の検出域47でのフォーカス位置の計測値に基づいてオートフォーカス制御が行われる。また、図13(h)に示すように、ショット領域SAが露光フィールド24を覆うようになったときには、露光フィールド24を覆う検出域46でのフォーカス位置の計測値に基づいてスキヤン方向のレベリング制御が行われ、露光フィールド24を覆う検出域47でのフォーカス位置の計測値に基づいてオートフォーカス制御が行われる。図13より、分割先読み法では、助

走スキャン長(=D/2)を完全先読み法に比べて1/2にできることが分かる。

【0095】なお、上述実施例においては、ウェハの露光面の多点のフォーカス位置を計測するために、2次元的に配列されたスリット状の開口パターン像をウェハ上に投影する多点フォーカス位置検出系が使用されている。しかしながら、その代わりに、非スキャン方向に細長いスリット状になっているパターンの像をウェハ上に投影し、その非スキャン方向の全体のフォーカス位置を計測する1次元のフォーカス位置検出系を使用しても良い。また、画像処理方式のフォーカス位置検出系を用いて、ウェハの露光面上の2次元的なフォーカス位置の分布を計測する場合でも、上述実施例と同様の分割先読み等を適用することにより、高精度なフォーカシング及びレベリングを行うことができる。更に、本例では図17より分かるように、非スキャン方向のレベリング誤差に対して、スキャン方向のレベリング誤差が小さいことから、スキャン方向のレベリング動作を行うことなく、非スキャン方向のみのレベリング動作を行っても良い。

【0096】なお、本発明は上述実施例に限定されず、本発明の要旨を逸脱しない範囲で種々の構成を取り得ることは勿論である。

【0097】

【発明の効果】本発明の第1の面位置設定装置によれば、スリットスキャン露光方式の投影露光装置において、感光基板の表面の凹凸、多点計測手段の計測精度、空気揺らぎ等による誤差を補正して、感光基板の露光面を投影光学系の像面に対して高精度に平行に合わせることが出来る利点がある。

【0098】また、多点計測手段が、基板側ステージを介して感光基板が走査されているときに、基板側ステージの位置基準で複数の計測点における感光基板の高さをサンプリングする場合には、より高精度に走査方向の傾斜角を計測できる。また、多点計測手段が、所定形状の照明領域と投影光学系に関して共役な露光領域内の複数の点及びその共役な露光領域内に対して感光基板が走査される際の手前の領域内の複数の点よりなる複数の計測点において、その感光基板の高さをそれぞれ計測する場合には、分割先読み制御により、露光の開始時の助走スキャン距離を短縮できる利点がある。

【0099】また、多点計測手段が、感光基板の1つのショット領域へ順次マスクのパターンを露光する過程において、順次複数の計測点の位置を変化させる場合には、例えば分割先読みと完全先読みとを併用することにより、レベリング精度及びスループットを共に改善することができる。また、本発明の第2の面位置設定装置によれば、スリットスキャン露光方式の投影露光装置において、感光基板の表面の凹凸、多点計測手段の計測精度、空気揺らぎ等による誤差を補正して、感光基板の露光面のフォーカス位置を投影光学系の像面に対して正確

に合わせることが出来る利点がある。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明による面位置設定装置の一実施例が適用された投影露光装置を示す構成図である。

【図2】(a)は実施例において投影光学系による露光フィールドを含む領域に投影された2次元的なスリット状の開口パターン像を示す平面図、(b)は多点フォーカス位置検出系のパターン形成板上の開口パターンを示す図、(c)は受光器上の受光素子の配列を示す図である。

【図3】(a)は実施例で分割先読みを行う場合のサンプル点を示す図、(b)は逆方向にスキャンする場合で且つ分割先読みを行う場合のサンプル点を示す図である。

【図4】(a)はフォーカス位置を先読みする場合を示す図、(b)は先読みしたフォーカス位置を用いて露光を行う場合を示す図である。

【図5】実施例のオートフォーカス及びオートレベリング機構並びにその制御部を示す構成図である。

【図6】フォーカス位置の計測値の補正方法の説明図である。

【図7】(a)は応答周波数 ν が10Hzの場合の伝達関数を示す図、(b)は図7(a)の伝達関数を逆フーリエ変換して得られた位置関数を示す図である。

【図8】(a)は隣接するショット領域へ露光を行う場合のウェハの軌跡を示す図、(b)はレチクルの走査時のタイミングチャート、(c)はウェハの走査時のタイミングチャートである。

【図9】(a)は露光位置制御法でレベリング及びフォーカシングを行う場合の追従精度を示す図、(b)は先読み制御法でレベリング及びフォーカシングを行う場合の追従精度を示す図である。

【図10】(a)は露光位置制御法を使用した場合の曲がりパラメータFに対する誤差パラメータSの計算結果を示す図、(b)は先読み制御法を使用した場合の曲がりパラメータFに対する誤差パラメータSの計算結果を示す図である。

【図11】(a)及び(b)は先読み制御法における平均化効果の説明図、(c)及び(d)は露光位置制御を行う場合のフォーカス面を示す図、(e)及び(f)は先読み制御を行う場合のフォーカス面を示す図である。

【図12】(a)及び(b)は露光位置制御を行う場合のフォーカス位置のサンプル点を示す平面図、(c)及び(d)は完全先読み制御を行う場合のフォーカス位置のサンプル点を示す平面図、(e)及び(f)は分割先読み制御を行う場合のフォーカス位置のサンプル点を示す平面図である。

【図13】(a)～(d)は完全先読み制御法で露光を行う場合の制御法の説明図、(e)～(h)は分割先読み制御法で露光を行う場合の制御法の説明図である。

【図14】(a)は一括露光を行う場合のフォーカス誤差を示す図、(b)はスリットスキャン露光方式で露光を行う場合のフォーカス誤差を示す図である。

【図15】(a)は計測値の最大値と最小値とを用いてオートフォーカス制御を行う場合のフォーカス誤差を示す図、(b)は計測値の平均値を用いてオートフォーカスを行う場合のフォーカス誤差を示す図、(c)は時間遅れ誤差を示す図、(d)はサーボゲインの変化を示す図である。

【図16】スリット状の露光フィールドでウェハ上のショット領域への露光を行う状態を示す平面図である。

【図17】(a)はスキャン方向の応答周波数と非スキャン方向の応答周波数とを等しくしてレベリング制御を行った場合の曲がりパラメータFに対する誤差パラメータSの計算結果を示す図、(b)はスキャン方向の応答周波数を非スキャン方向の応答周波数より高くしてレベリング制御を行った場合の曲がりパラメータFに対する誤差パラメータSの計算結果を示す図である。

【図18】(a)はフォーカス位置の平均値を用いてオートフォーカス制御を行う状態を示す図、(b)はフォーカス位置の最大値及び最小値の平均値を用いてオートフォーカス制御を行う状態を示す図である。

【図19】(a)は図17(a)の状態において更に平均化処理でオートフォーカス制御を行った場合の曲がりパラメータFに対する誤差パラメータSの計算結果を示す図である。

す図、(b)は図17(b)の状態において更にフォーカス位置の最大値及び最小値の平均値を用いてオートフォーカス制御を行った場合の曲がりパラメータFに対する誤差パラメータSの計算結果を示す図である。

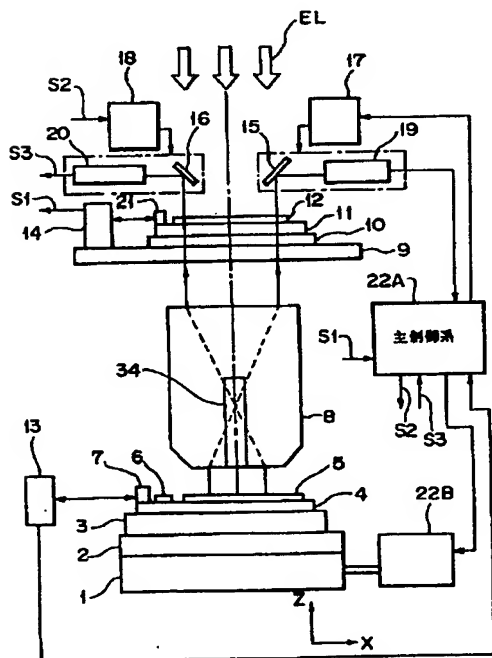
【図20】従来のステッパーにおける多点フォーカス位置検出系を示す構成図である。

【図21】(a)は図20において投影光学系による露光フィールドを含む領域に投影された2次元的なスリット状の開孔パターン像を示す平面図、(b)は図20の多点フォーカス位置検出系のパターン形成板上の開孔パターンを示す図、(c)は図20の受光器上の受光素子の配列を示す図である。

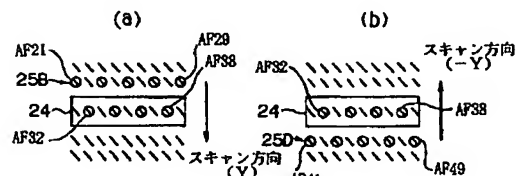
【符号の説明】

- 2 ウェハY軸駆動ステージ
- 4 Zレベリングステージ
- 5 ウェハ
- 8 投影光学系
- 10 レチクルY駆動ステージ
- 12 レチクル
- 22A 主制御系
- 24 スリット状の露光フィールド
- 62A パターン形成板
- 69A 受光器
- 71A 信号処理装置
- AF11～AF59 計測点

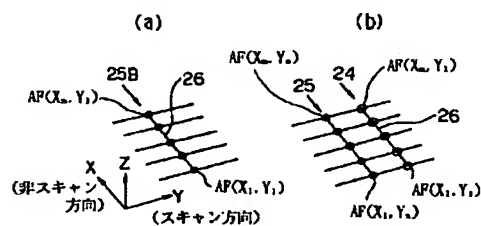
【図1】



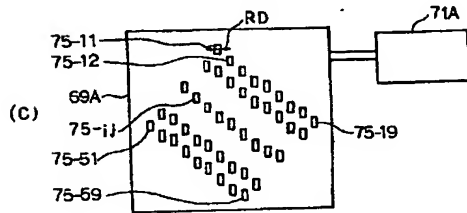
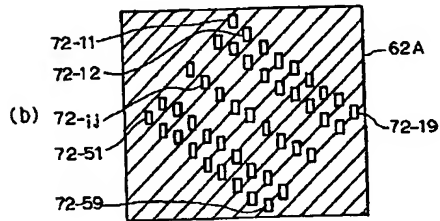
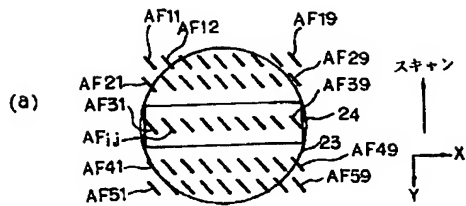
【図3】



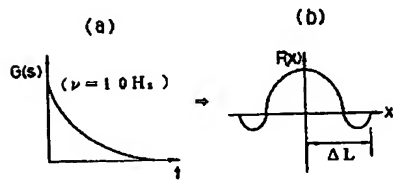
【図4】



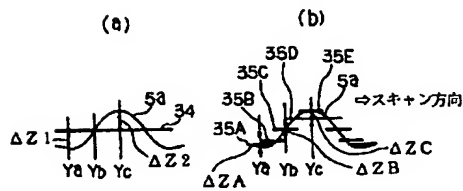
【図2】



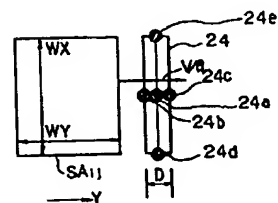
【図7】



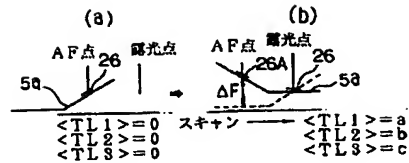
【図14】



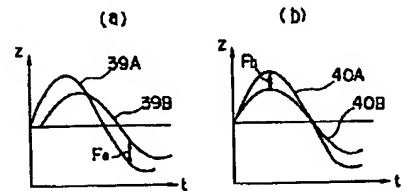
【図16】



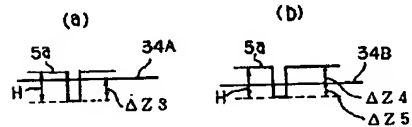
【図6】



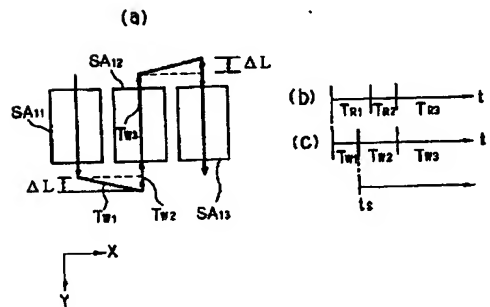
【図9】



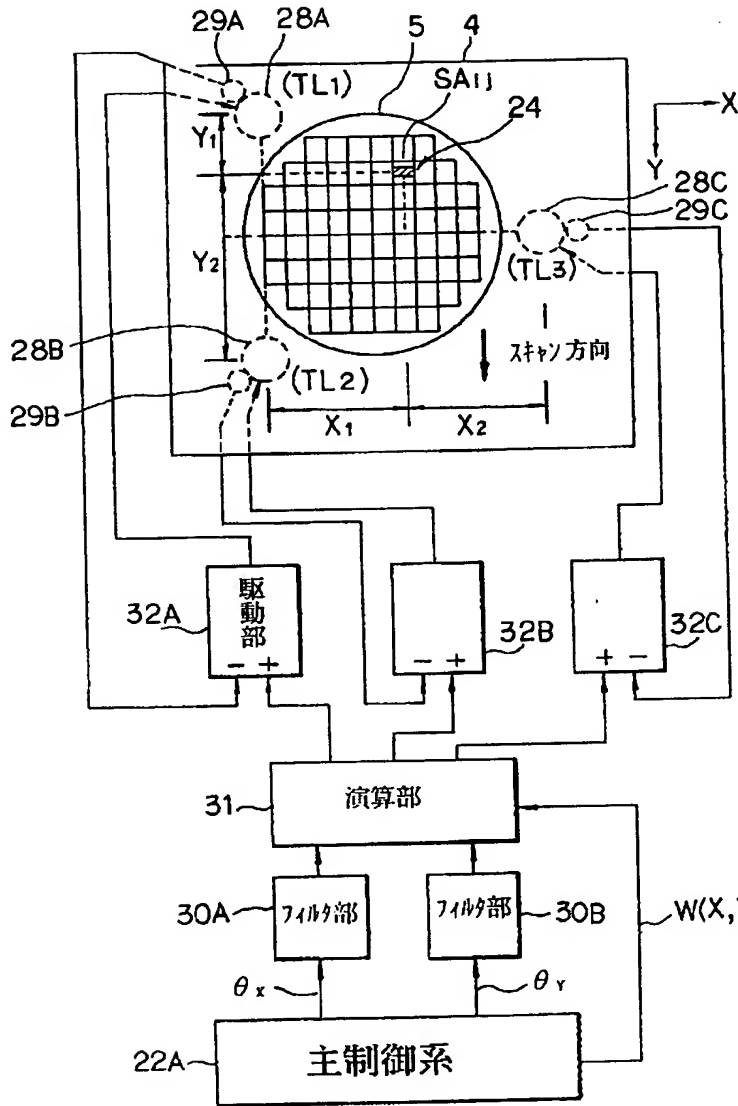
【図18】



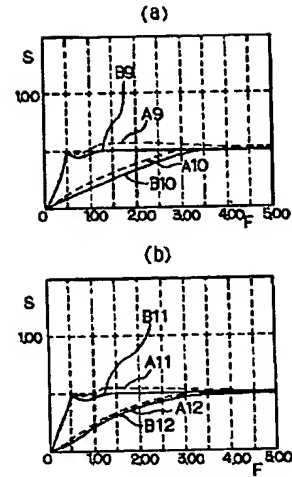
【図8】



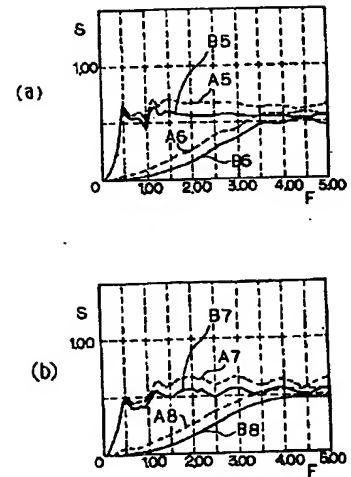
【図5】



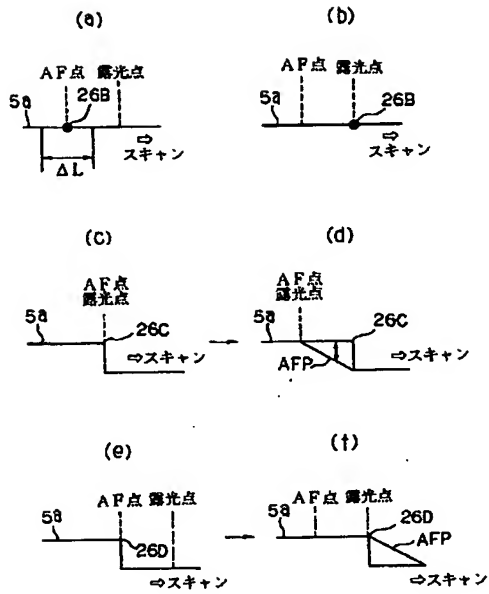
【図10】



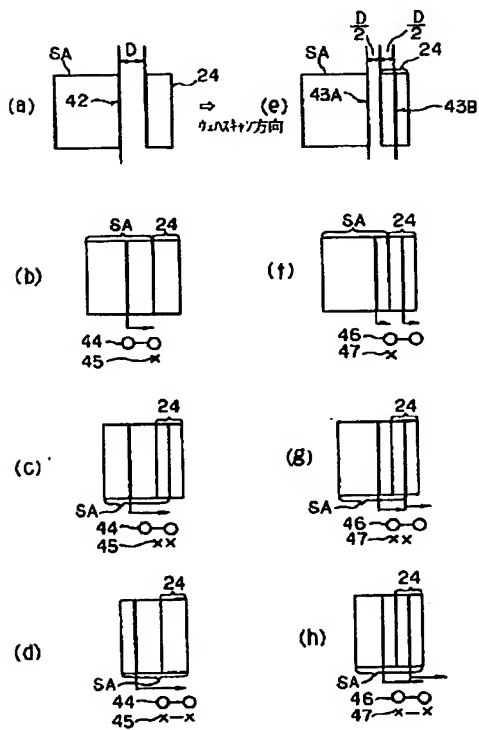
【図19】



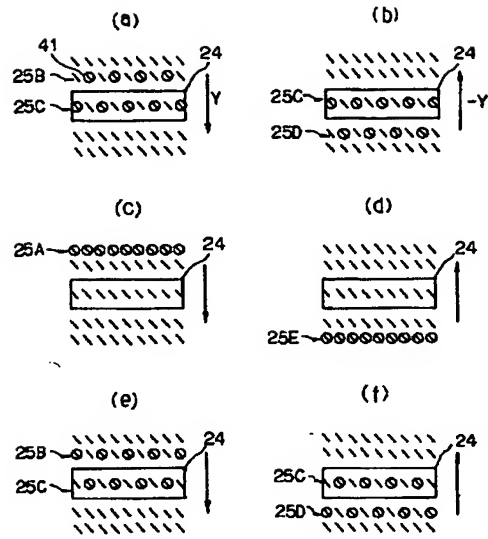
【図11】



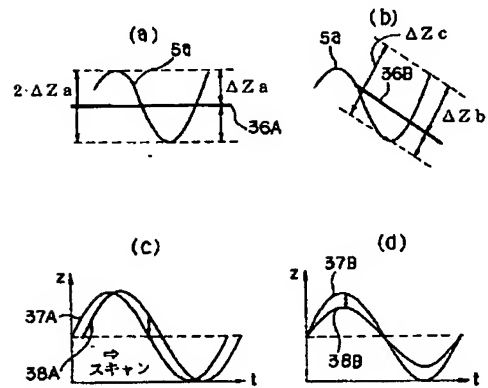
【図13】



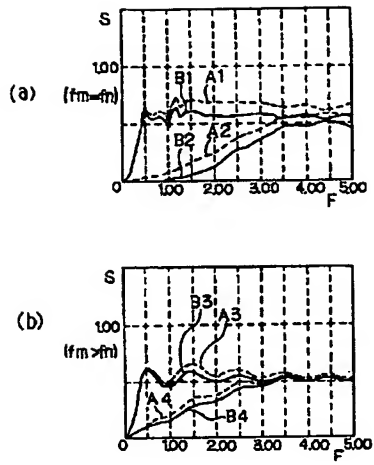
【図12】



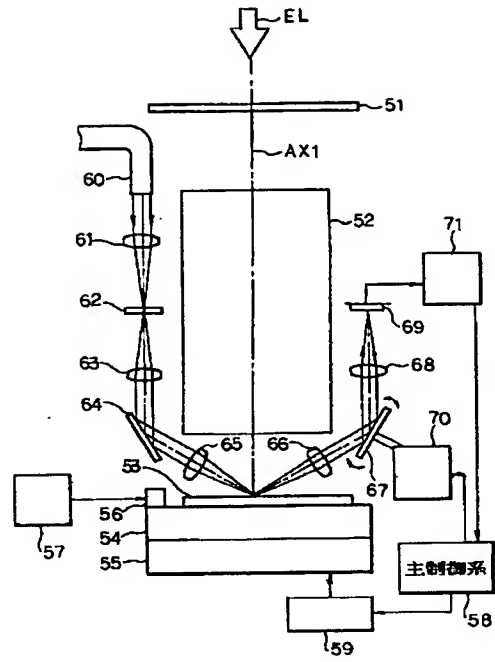
【図15】



【図17】



【図20】



【図 21】

